INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO BR9032539 エルエS-BR--ユギギ

FOTODISSOCIAÇÃO DE IONS OH- EM CRISTAIS DE ROCI

Sonia Licia Baldochi

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do Grau de "Mestre na Área de Concentração em Tecnologia Nuclear Básica".

Orientador: Dr. Spero Penha Morato

1

FOTODISSOCIAÇÃO DE IONS OH EM CRISTAIS DE ROCL

ERRATA

```
página 8 - linha 19
onde se lê: "de carga de um elétron de um átomo halogênio
            para um átomo.."
 leia-se : "de um elétron de um átomo halogênio para um
            átomo.."
página 42 - figura §4.2 (legenda)
onde se lê: 1 - irradiado por 75 min.
            2 - irradiado por 45 min.
  leia-se ! 1 - irradiado por 45 min.
            2 - irradiado por 75 min.
página 62 - figura §4.9 (linha 3)
onde se lê: OH . CN
                       , CH, U2 e C, versus o tempo..
 leia-se : ON . CN , OH , U2 e X , versus o tempo..
página 75 - linha 23
onde se lê: "truição da absorção relativa aos agregados e.."
 leia-se : "truição parcial da absorção relativa aos agre
            gados e ... "
```

INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES AUTARQUIA ASSOCIADA À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FOTODISSOCIAÇÃO DE IONS OHT EM CRISTAIS DE RECI

Sonia Licia Baldochi

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do Grau de "Mestre na Área de Concentração em Tecnologia Nuclear Básica".



.

. . .

Orientador: Dr. Spero Penha Morato

SÃO PAULO 1985

Aos meus pais Ulysses 2 Dilma.

ţ

2 2 3

1

.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao Dr. Spero Penha Morato pela orientação, amizade, estimulo e confiança na realização de<u>s</u> te trabalho e pela constante e paciente colaboração para que o mesmo fosse concluido.

Agradeço ainda:

A Maria Silvia Gorski pela iniciação cientifica.

A Lúcia Prado pela amizade e acompanhamento de minha conduta experimental.

A Laêrcio Gomes pelas proveitosas discus sões na elaboração final deste trabalho.

A Vera L.R. Salvador pela colaboração nas irradiações com raios X.

Ao engenheiro Gessé E.C. Nogueira pela colaboração na manutenção dos equipamentos.

Ao IPEN pelo apoio financeiro.

A Rosana, Pei Jen, Rubens, Oscar e Miriam pela amizade e incentivo em todos os instantes.

A Yvone pela datilografia e no Brandão p<u>e</u> la rāpida confecção das figuras.

Aos colegas e demais pessoas que direta ou indiretamente contribuiram para a concretização deste trabalho.

A meus pais e minha îrmã Silviz pelo carinho, confiança e apoio, sem os quais este trabalho não teria sido realizado.

SONTA LICIA

Ì

1

ş

1

FOTODISSOCIAÇÃO DE IONS OH EM CRISTAIS DE ROCL

SONIA LICIA BALDOCHI

RESUMO

Utilizando-se a técnica de absorção óptica na região do visível e do ultravioleta, estudou-se os de feitos primários e secundários obtidos após a fotodissociação de íons OH em cristais de RbCl submetidos a radiação UV ou X, no intervalo de temperatura de 77 a 300 K. Observou-se que os mecanismos básicos da fotodissociação OH se mantem inalterados, sendo o processo análogo à outros haletos alcalinos.

Devido a presença de impurezas moleculares CN em uma das amostras utilizadas, observou-se que estes ions interagem com os ions OH, alterando o processo de fotodissociação. Os resultados da fotodissociação OH no RbCl:OH + CN, permitiram propor a existência de novos de feitos. Estes defeitos são agregados da forma OH . CN , caracterizado por uma absorção eletrônica em 1940 A e uma absorção vibracional-rotacional em 2165cm⁻¹, e [O]. [N] com absorção eletrônica característica em 2040 A. Uma pro priedade do centro complexo OH . CN encontrada é que este permite a fotodissociação da impureza OH, por irradia ção X ou UV, à temperatura ambiente, dando origem a centros U e 0. CN. A coloração aditiva do cristal Ri Cl: OH + CN mostrou também que é possível obter-se centros U formados diretamente da dissociação do OH na presen co do impurezas [CN].

PHOTODISSOCIATION OF OH TIONS IN RECL CRYSTALS SONIA LICIA BALDOCHI A B S T R A C T

Experiments utilizing optical absorption tecniques in the visible and ultraviolet spectral regions have been performed to study the primary and secondary defects from the photodissociation of the OH ion in RbCl crystals, over the 77 to 300 K temperature range. It was observed that the basic mechanism of the OH photodissociation is the same as the other alkali halides doped with OH.

Due to the presence of the CN molecular impurity in one of the samples used, it has been observed that these ions interact with the OH impurities changing the photodissociation process. The experimental observation of OH photodissociation in RbCl: OH + CN allowed us to propose new aggregated defects. These defects are complex centers in the form of OH . CN characterized by an eletronic absorption at 1940 Å and a vibrational-rotational absorption at 2165 cm⁻¹, and in the form $\left[\overline{O}\right]$. $\left[\overline{CN}\right]$ with a characteristic eletronic absorption at 2040 Å. One property of the complex center [OH]. CN] observed is that it allows photodissociation of the OH impurity, by X and UV irradiation, at room temperature producting U and 0. CNcenters. The additive coloration of the RbCl: OH + CN also showed that it's possible to obtain U centers directly from the OH dissociation in the presence of CN impurities.

INDICE

•

CAPÍTULO	I - INTRODUÇÃO E OBJETIVOS	1
CAPÍTULO	II - CONSIDERAÇÕES GERAIS	
II.1	Dano por radiação de baixa energia nos	
	haletos alcalinos	4
	II .l.l Produtos primários do dano de r <u>a</u>	
	diação ã baixa temperatura nos	
	haletos alcalinos	5
II.2	A impureza OH nos haletos alcalinos.	
	Propriedades ópticas	8
II.3	Fotodissociação OH nos haletos alcalinos	10
	II.3.1 Produtos secundários da fotodisso-	
	ciação OH	12
	II.3.2 Fotodissociação OH em presença	
	de centros F	18
11.4	Centros F	19
	II.4.1 Agregados de centros F	21

CAPÍTULO III - PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

•

111.1	Considerações gerais sobre as amostras	
	utilizadas	23
	III.l.l Preparação das amostras	24
III.2	Criostato	25
	III.2.1 Tratamento térmico pulsado	28

Pág.

CAPÍTULO IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO

IV.1	Fotodis	sociação <u>OH</u> no RbCl - 2080	40
IV.2	Tratame	nto térmico no RbCl - 2080	45
IV.3	Fotodis	sociação OH no RbCl - 1200	53
	IV.3.1	Impureza CN	54
	IV.3.2	Interação das impurezas OH	
		e <u>CN</u>	56
	IV.3.3	Fotodissociação	58
	IV.3.4	Tratamento térmico	68
	IV.3.5	RbCl - 1200 e centros F	73
CAPÍTULO	v – coi	NCLUSÕES	83
REFERÊNCI	AS BIBLI	OGRÁFICAS	87

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

Devido a sua simplicidade estrutural e química, cristais haletos alcalinos constituem bons materiais modelo para estudos de danos de radiação, pois OS resultados neles obtidos podem ser facilmente extrapolados para materiais com estruturas cristalinas mais complexas. Além disto, cristais haletos alcalinos são sólidos ideais para estudos teóricos e experimentais nesta área, pois apresentam grande espaçamento entre as bandas eletrônicas, o que acarreta a existência de uma larga região espectral com alta transmitância (janela óptica) que pode ser alterada em cristais nos quais são produzidos defeitos ou introduzidas impurezas.

Recentemente, o estudo de impurezas moleculares em cristais ganhou uma importância tecnológica muito grande, devido a aplicação dos conhecimentos adquiri dos com impurezas CN⁻ na construção do primeiro laser vibracional de estado sólido ⁽¹⁾. Nossos estudos tem por base a impureza molecular OH⁻; esta impureza em haletos al calinos, fotodissocia-se sob irradiação UV à temperaturas abaixo de 200 K, constituindo uma fonte de átomos e fons de hidrogênio que podem ocupar posições substitucionais ou intersticiais no cristal. Impurezas de hidrogênio além de serem as mais simples imperfeições extrínsecas que se pode encontrar nos materiais, são excelentes testes para modelos quanto-mecânicos de defeitos em cristais.

Vários estudos já foram realizados, por diversos autores, sobre o processo de fotodissociação da impureza OH em cristais haletos alcalinos, tais como: efi ciência do processo com a temperatura, formação e destruição dos defeitos primários e secundários da fotoreação OH, suas propriedades e suas aplicações. A maior parte destes estudos tem sido realizados em cristais de cloreto de potássio (KCl), que entre os haletos alcalinos constitui o material mais extensamente utilizado, por ser considerado como modelo quando se deseja estudar um novo mecanismo. Os resultados observados no KCl são normalmente extrapolados para outros haletos alcalinos. Entretanto estudos recentes da dinâmica de associação e dissociação de defeitos, produtos da fotodissociação OH⁻, em cristais de iodeto de potássio (KI) ⁽²⁾ mostraram que de acordo com o espaçamen to interatômico da rede hospedeira, podem ser formados diferentes configurações de defeitos. Devido a isto, optamos por estudar os mecanismos básicos da fotodissociação da impureza OH no cloreto de rubídio (RbCl), que apresenta estrutura cristalina análoga ao KCl e ao KI mas diferente parâmetro de rede. A tabela I fornece, a título de compara ção, os parâmetros de rede dos três cristais citados.

TABELA I

Parâmetro de rede de cristais haletos alcalinos

	KCl	RbCl	KI	
a (Å)	3,14	3,27	3,53	

O presente trabalho compreende os seguintes tópicos: no Capítulo II apresentaremos considerações gerais sobre danos de radiação e sobre a impureza OH e o processo de fotodissociação, sendo dada ênfase aos aspectos mais diretamente ligados à presente dissertação. No capítulo III, segue a descrição de nossos arranjos experimentais e finalizando nos capítulos IV e V as experiências realizadas e conclusões.

CAPÍTULO II

CONSIDERAÇÕES GERAIS

II.1 DANO POR RADIAÇÃO DE BAIXA ENERGIA NOS HALETOS ALCALINOS

Quando cristais iônicos são sujeitos à radiação, várias alterações podem ocorrer nos íons da rede e nas impurezas presentes, dando origem a defeitos. Entr<u>e</u> tanto pode-se agrupar os produtos finais dessas alterações em tres categorias ⁽³⁾:

- a) Defeitos Eletrônicos
- b) Defeitos Iônicos
- c) Imperfeições grosseiras

Defeitos eletrônicos envolvem mudanças nos estados de valência devido ao aprisionamento de elétrons e buracos criados na rede devido à irradiação. Pode ocorrer com impurezas presentes na rede, em defeitos intrínsecos do cristal ou mesmo com íons da rede perfeita.D<u>e</u> feitos ionicos resultam do deslocamento de íons da rede, como vacâncias e átomos ou íons intersticiais. As imperfeições grosseiras compreendem as discordâncias e "vazios" (voids), que envolvem alterações em planos inteiros do cristal. Os mecanismos pelos quais esses defeitos podem ser produzidos resumem-se nas seguintes classes ⁽⁴⁾:

- a) Processos Eletrônicos
- b) Colisões Elásticas
- c) Radiólise

No processo eletrônico, a energia é transferida ao sistema eletrônico do cristal; um estado eletrônico é alterado ou uma carga é deslocada devido a absorção de energia radiante, mas sem envolver a formação de defeitos atômicos ou iônicos. Na classe das colisões elásticas os átomos ou fons são deslocados devido à transf<u>e</u> rência de momento e energia pelas partículas incidentes. P<u>e</u> lo processo de radiólise são produzidos os defeitos atôm<u>i</u> cos ou iônicos como resultado final de uma série de reações iniciadas com uma excitação eletrônica. Como veremos a seguir, por radiólise, à baixas temperaturas (T < 10 K), podemos ter a formação de defeitos Frenkel que constituem os produtos primários da radiação nos haletos alcalinos.

II.1.1 - Produtos primários do dano de radiação à baixa temperatura nos haletos alcalinos

Radiação ultravioleta ionizante é capaz de produzir à baixas temperaturas (T < 10 K) defe tos Frenkel na subrede aniônica do cristal. Dois tipos de defeitos aniônicos são formados: pares Frenkel carregados, que consistem de uma vacância aniônica (centro α) e um fon haleto intersticial, e pares Frenkel neutros que consistem de uma vacância aniônica com um elétron (centro F) e um átomo haleto intersticial. Tomando-se como exemplo um cloreto, as reações de formação serão respectivame e:

$$Cl + hv + \Box + Cl_i (centros \alpha e I)$$
(2.1)

 $C1 + hv + e + Cl_{i}^{o} (centros F e H)$ (2.2)

São considerados como produtos primári os do processo de dano de radiação os pares Frenkel neutros (centros F e H); os pares Frenkel carregados são formados posteriormente por um processo eletrônico que transfere um elétron de um centro F para um centro H, sendo este processo um efeito secundário.

Toyozawa⁽⁵⁾, em 1974, explicou o processo de formação de centros F e H pcr irradiação à baixas temperaturas da seguinte maneira: a radiação produz inicialmente elétrons e buracos de alta energia, o buraco é imediatamente auto-aprisionado (centro V_k); o elétron perde energia através de elétrons secundários e fonons óp ticos, sendo finalmente aprisionado por um centro V_k. 0 elétron inicialmente ocupa os níveis mais energéticos е decai rapidamente para o nível excitado de menor energia do centro V_k , o estado $2p_2$. O centro V_k possui a configu ração de um ion molecular x_2^- , onde os dois ions de halogê nios estão mais próximos do que na posição regular. 0 efeito é o de um par de semi-vacâncias diametralmente 0-

postas no mesmo eixo que contém o centro V,, cada uma delas com carga efetiva +|e|/2. O estado $2p_z$ é o nível ex citado de menor energía por estar localizado ao longo da direção <110> utilizando a região de potencial atrativo das duas semi-vacâncias. O elétron excitado, que ocupa o estado $2p_z$ do centro V_k , quando relaxa, força o desloca mento do ion molecular para uma das semi-vacâncias, ficando portanto inteiramente localizado na semi-vacância oposta. A relaxação do elétron $2p_z$ pode fornecer energia cinética suficiente para que a molécula X_2^{-} mova-se na direção <110> em uma sequência de colisões (Mecanismo de Varley) ⁽⁶⁾. O ion molecular X_2^- irá finalmente se estabilizar na configuração de um "crowdion" (centro H) em uma posição afastada do elétron 1s e da vacância aniônica (ou centro F). A transição do estado 2p, para 1s pode ocorrer também através de uma transição radioativa; o elétron $2p_z$ do centro V_k decai para o estado ls por emissão de fótons, posteriormente o sistema decai por emissão lumines cente e a rede recompõe-se, não havendo formação de defeitos. Existe portanto dois canais competindo: um conduzindo a formação de centros de cor (centros F e H) e outro conduzindo a luminescência intrínseca e portanto não produzindo defeitos na rede.

O processo de formação de centros F e H, conforme descrição acima, constitui um exemplo de um processo elementar típico de dano de radiação num cristal iônico.

II.2 A IMPUREZA OH NOS HALETOS ALCALINOS.

PROPRIEDADES OPTICAS

A molécula diatômica OH nos haletos alcalinos é incorporada substitucionalmente à rede, na po sição de um fon de halogênio⁽⁷⁾. Analogamente a uma molécu la diatômica livre, o fon OH nos haletos alcalinos apresenta três tipos de excitação óptica: absorção eletrôni ca^(8,9), vibracional ^(8,10) e rotacional ^(11,12,13). A absor ção eletrônica consiste de uma banda larga e sem estrutura na região espectral do UV (5 a 7 eV) próxima à absorção eletrônica fundamental do cristal, apresentanto um pequeno estreitamento à baixas temperaturas.

Kostlin ⁽¹⁴⁾ propôs que a banda de absorção UV do OH⁻, seja devida a uma transição eletrônica análoga à primeira absorção de excitons nos cristais haletos alcalinos. Para explicar o espectro excitônico dos haletos alcalinos, Hislch e Pohl ⁽¹⁵⁾, consideram que o efeito primário da absorção de um fóton é o da transferência de carga de um elétron de um átomo halogênio para um átomo alcalino vizinho mais próximo ou "mecanismo de absorção por transferência de carga". Com base neste modelo pode-se explicar qualitativamente que a banda de absorção UV do fon OH se refere à transição eletrônica do estado fundamental do OH para c estado excitônico da rede. Cálculos teóricos da transição UV do Ion OH efetuados por Chae e Dick (16) utilizando a função de onda do estado eletrônico fundamental para o fon OH livre e o modelo de transferência de carga, mostraram razoável concordância entre os valores das energias de transição calculados e os valores medi-

dos experimentalmente.

A posição do máximo da banda OH[®] segue a relação empírica de Mollwo-Ivey que relaciona a distância entre os vizinhos mais próximos (d) e a frequência do máximo da banda ^(8,17):

$$v_{\rm max} = 691 \, {\rm d}^{0,95}$$
 (2.3)

Kapphan ⁽¹⁷⁾ calculou as posições dos máximos das bandas de absorção UV do OH[®] para onze haletos alcalinos com base no modelo de transferência de carga e comparou com os valores calculados pela relação (2.3) tendo obtido uma concordância dentro de 93%.

O espectro vibracional do ion OH consiste inicialmente de uma banda no infravermelho próximo (cerca de 2,7 µ) provocada pela excitação óptica do modo vibracional de "estiramento" ("Stretching") da molécula OH (8,10). A intensidade de absorção desta banda, em geral muito pequena, varia consideravelmente para diferentes haletos alcalinos e a mesma apresenta uma largura de linha es treita a baixas temperaturas. Uma banda secundária aparece na região espectral de maior energia, separada de uma distância de aproximadamente 300 cm⁻¹ da banda relativa ao modo vibracional de estiramento. Alguns autores consideram na como devida a uma excitação do modo vibracional de estiramento acoplado ao modo vibracional de deformação angular ("librational") da molécula OH^{- (11)}.

Próxima a absorção fundamental vibracional, no infravermelho distante, observa-se uma terceira banda. Harrison e Luty ⁽¹²⁾ propuseral que esta banda pode ser visualizada como uma "distorção" da excitação rotacional da molécula OH⁻ livre; quando o íon OH⁻ é introduzido no cristal, o rotor livre é colocado em um potencial cristalino octaédrico, que impede seu movimento "normal",
e modifica consideravelmente os níveis de energia do rotor livre. Esta banda pode então corresponder a excitação óptica do modo vibracional de deformação angular do íon OH⁻ (vibração do íon OH⁻ ao redor de suas 12 orientações de equilíbrio na rede cristalina).

II.3 FOTODISSOCIAÇÃO OH NOS HALETOS ALCALINOS

Como demonstrado inicialmente por Kerkoff ⁽¹⁸⁾, a excitação óptica da transição responsável pela banda UV do Ion OH, dã origem, à baixas temperaturas, a um processo de fotodissociação,

o centro \boxed{O} apresenta uma banda de absorção eletrônica na ragião da absorção fundamental do cristal, sendo muito difícil estudá-lo por técnicas de absorção óptica. Medidas de EPR realizadas após o processo de fotodissociação (T = 77K) registraram apenas a presença de centros U₂ não sendo observada a presença de centros \boxed{O} (21). Devido a estes problemas a sua estrutura microscópica ainda é uma incógnita. Entretanto a validade básica de fotoreação 2.4 é geralmente aceita pois os modelos dos defeitos \boxed{OH} e H_i^O são amplamente confirmados.

A princípio, acreditava-se que a efici ência do processo de fotodissociação fosse extremamente de pendente da temperatura, sendo possível somente a baixas temperaturas (T < 100K).Morato e Luty⁽²²⁾, demonstraram para o KCl, que o processo fundamental da fotodissociação ocorre com eficiência similar em uma faixa de temperatura de 6 a 300K, sendo que as diferenças observadas na fotoquímica do processo em diversas temperaturas são devidas a diferenças na estabilidade, mobilidade e excitações ópti cas secundárias dos produtos primários da fotoreação 2.4. Longos períodos de irradiação, tratamentos térmicos e irra diações com fonte de larga faixa espectral produzem reações secundárias conduzindo a formação de outros centros do tipo U (centros U e U1), vacâncias livres e vacâncias com elétrons aprisionados (centros a e F, respectivamente) e centros do tipo V (centros H e V_1) (9,23). A figura 2.1 mostra os modelos estruturais dos centros citados.

12.

FIGURA 2.1 - Mcdelos Estruturais dos Centros Estudados Plano Cristalino 100

II.3.1 - Produtos secundários da fotodissociação

Nos itens a seguir forneceremos algumas características dos principais centros observados em processos secundários da fotodissociação do ion OH em alguns cristais de haletos alcalinos.

a) <u>Centros U</u>2

Os centros U_2 produzidos pela fotodi<u>a</u> sociação dos defeitos OH, são átomos de hidrogênio intersticiais isolados e não perturbados, extensamente est<u>u</u> dados por técnica s de absorção óptica, ESR e ENDOR em vá rios haletos alcalinos (19,20,24). Ele pode ser produzido pela fotodissociação de qualquer molécula do tipo XH⁻, on de X representa um elemento do grupo VI (S, Se, Te, C). (25,26,27)

Quando aprisionado na posição intersticial o átomo de hidrogênio apresenta uma banda de absor ção eletrônica na região do UV. A tabela II fornece características desta banda para alguns haletos alcalinos, a 77K.

TABELA II

Propriedades da absorção U_2 em haletos alcalinos (23)

	λ(Α)	f	H(eV)
KCl	2550	0,33	0,42
KBr	2720	0,41	0,39

A transição responsável pela banda U₂ foi inicialmente descrita por Kerkoff como a excitação de um buraco positivo, que no estado eletrônico funda mental deste centro está principalmente ligado ao hidr<u>o</u> gênio e no estado excitado está mais fortemente ligado a quatro fons de halogênio vizinhos mais próximos⁽²⁸⁾.

A excitação óptica da transição responsável pela banda U₂ e/ou a ativação térmica do cristal contendo estes centros pode levar a formação de novas $i\underline{m}$ perfeições. Kurz⁽²⁸⁾ sugeriu que o primeiro processo a

ocorrer após a excitação do centro U_2 é a relaxação não cú bica da rede, onde o íon de hidrogênio desloca-se ao longo da direção <100> e os íons de helogênio na direção <110>. Ocorre também uma polarização da distribuição de carga alterando o potencial no qual o hidrogênio está imerso, tornando o buraco mais localizado entre dois íons de halogênio que se tornam mais próximos. Nesta situação pode ocorrer uma aniquilação entre o elétron e o buraco mais localizado restaurando a configuração original H_1^0 ou um escape a esta aniquilação conduzindo a formação de novas imperfeições.

b) Centros $H_2 O = U_{2x}$

Os centros H_20^- foram descobertos por Rusch e Siedel⁽²⁹⁾, em estudos realizados à baixas temper<u>a</u> turas. Após efetuarem várias medidas de EPR e ENDOR eles propuseram o seguinte modelo para este defeito (29,30): centro H₂0 pode ser considerado como um centro F perturba do por uma molécula de água embebida nele. Mais recentemen te Gomes⁽³¹⁾ realizou estudos do centro H_2^{0} à altas temperaturas (T $\stackrel{\sim}{=}$ 150 K) no KCl e KBr e observou que o centro po de ser produzido diretamente da fotodissociação OH ou por um processo térmico com dois estágios que envolve um novo centro chamado U_{2x} . No primeiro estágio os centros U_{2} , pro duzidos inicialmente pela fotodissociação OH, tornam-se instáveis por ativação térmica, podendo reagir com seus anti-centros O, centros U₂ e centros OH. Duas configura ções podem ser obtidas: uma delas consiste do centro H_2^0

propriamente dito, produzido por um armadilhamento direto e definitivo do átomo de hidrogênio por um ion OH, seguin do a cinética direta proposta por Rusch e Siedel ⁽³⁰⁾:

$$U_2 + OH^- + H_2O^-$$
 (2.5)

A segunda configuração envolve a formação do centro U_{2x} , proposto como um centro U_2 estabilizado à altas temperatu ras, próximo a uma impureza OH. O centro U_2 não é pro priamente aprisionado pela impureza mas forma com ele um defeito molecular do tipo $U_2.OH$, sendo sua formação representada pela equação:

$$U_2 + OH^- + U_2.OH^- (centro U_{2x})$$
 (2.6)

No segundo estágio, ocorre a conversão dos centros U_{2x} em centros H_2O . Gomes ⁽³¹⁾ argumenta que o modelo inicialmente proposto é válido somente à bai xas temperaturas e propõe um novo modelo, onde o centro H_2O pode ser visualizado como um centro F perturbado, contendo uma molécula OH com um átomo de hidrogênio nela aprisionado, tendo-se portanto dois prótons a distâncias distintas do oxigênio. Este modelo ainda apresenta caráter de centro F, semelhante ao proposto inicialmente por Rusch e Siedel, mas discorda com a proposição da formação de uma molécula de água no centro H_2O .

A absorção do centro H_2O , no KCl e KBr, consiste de uma banda com estrutura complexa, compo<u>s</u> ta de quatro bandas nas proximidades da banda F. O centro U_{2x} , por sua vez, apresenta uma banda de absorção eletrônica independente na região espectral do UV.

c) Centros U

Um segundo método para se obter vários centros de hidrogênio em haletos alcalinos é utilizar como material inicial, cristais dopados com fons H (em vez de ions OH). Conforme demonstrado inicialmente por Pohl^(32,33), ions de hidrogênio (H⁻), podem ser incorporados substitucionalmente a haletos alcalinos. Estes defeitos chamados centros U, produzem uma banda de absorção eletrônica intensa na região espectral do UV e uma banda de absorção na região IV devida a uma vibração localizada do ion hidrogênio⁽³⁴⁾. Irradiação UV na banda U, à baixas temperaturas, transfere o ion H para uma posição intersticial, resultando na formação de centros U_1 (H_i) e centros α ⁽³⁵⁾. Irradiação por períodos mais prolongados com fonte UV de larga faixa espectral, pode excitar a transição responsável pela banda U_1 do fon H_1^- levando a sua ionização, ocorrendo o retorno do elétron para a vacância aniônica⁽³⁵⁾. Estes processos podem ser representados pelas seguintes equações:

$$H^{-} + hv + H^{-} + H^{-}$$
(2.7)
$$H^{-} + H^{-} + hv + e^{-} + H^{0}$$
(2.8)

Além destas configurações de defeitos hidrogênio, uma quarta configuração, que consiste de um ātomo neutro de hidrogênio em um sítio da rede anteriormen

te ocupado por um ânion (centro U₃), foi detectado em pe-(36) quenas quantidades por têcnicas de ressonância magnética.

Como produto secundário da fotodissoci<u>a</u> ção \overrightarrow{OH} , os centros U foram observados por Morato ⁽²¹⁾ no KCl colorido aditivamente. À temperaturas próximas da temperatura ambiente (T > 250 K), em presença de centros F (\overrightarrow{e}) Morato obteve como resultado final do processo de fotodissociação a seguinte reação⁽¹²⁾:

$$\overrightarrow{OH} + \overrightarrow{e} + h\nu \rightarrow \overrightarrow{O} + \overrightarrow{H}$$
(2.9)

Esta reação representa um interessante efeito físico. Sabe-se que cristais haletos alcalinos coloridos aditivamente são bastante estáveis quanto a sua coloração, sendo muito difícil a obtenção de um "bleaching" permanente e completo de sua coloração. Quando irradiados com luz visível à baixas temperaturas, ocorre nestes sistemas a reação reversível F + F' e à altas tempe raturas observa-se a agregação em complexos F_2 , F_3 e outros. O mesmo comportamento é observado quando cristais haletos alcalinos coloridos aditivamente e dopados com im purezas OH são irradiados com luz visível, entretanto es tes mecanismos se alteram quando estes mesmos cristais são irradiados com luz ultravioleta, como demonstra a equação 2.9. Morato⁽²¹⁾ observou que ocorre um destruição com pleta e irreversível dos centros F, não sendo portanto observada absorção na região visível, mas somente na região UV devido aos centros H e O produzidos no processo. Este comportamento de cristais coloridos adi-

tivamente dopados com impurezas OH, de tornar a radiação UV detectável por um efetivo e estável "bleaching" da co loração visível, oferece interessantes possibilidades pur ra armazenamento de informações ópticas.

II.3.2 - Fotodissociação OH em presença de centros F

O processo de fotodissociação <u>OH</u> no KCl na faixa de temperatura de 100 a 300 K pode ser representado pelas seguintes equações ⁽²¹⁾:

$$OH^{-}$$
 + hv + O^{-} + H_{1}^{O} (T = 100 K)
 OH^{-} + H_{1}^{O} + KT + $H_{2}O^{-}$ (T = 120-200K)
(2.10)

À temperaturas acima de 250 K, os produtos primários e secundários da fotodissociação OH^- são todos instáveis, prevalencendo como reação principal a recombinação dos fons OH^- .

O processo de fotodissociação OH^- na mesma faixa de temperatura realizado em KCl colorido aditivamente, isto é, em presença de centros F, apresenta d<u>i</u> ferentes canais de reação. As equações que representam a fotodissociação no KCl:OH⁻ + F, são as seguintes ⁽²¹⁾:

$$\begin{array}{c} OH^{-} + e^{-} + hv \rightarrow O^{-} + H^{O}_{i} + e^{-} & (T = 100K) \\ e^{-} + hv \rightarrow P + e^{-} & (2.12) \end{array}$$

$$e^{-} + H_{i}^{O} + KT + H_{i}^{-} (T > 120 K)$$
 (2.13)

$$H_{i}^{-}$$
 + H_{i}^{-} + KT + H_{i}^{-} (T + 150K-300K) (2.14)

A presença de centros F altera a natureza da fotoquímica OH nos haletos alcalinos devido ao fato destes defeitos, principalmente em temperaturas mais elevadas, agirem como "sítios de reação e armadilhas adicionais", estabilizando alguns produtos instáveis termicamente da fotoreação OH, como por exemplo os centros U $(H) = U_1 (H_1)$.

II.4 CENTROS F

O centro F consiste de um elétron apr<u>i</u> sionado em uma vacância aniônica, sendo que, nos haletos alcalinos o elétron é compartilhado pelos seis cátions vizinhos à vacância. Estes centros podem ser produzidos nos haletos alcalinos por coloração aditiva ou por diferentes tipos de radiação como raios X, raios γ , ou por feixe pulsado ^(6,37).

A banca F consiste de uma banda de absorção simples cuja posição espectral elargura depende da natureza do haleto alcalino e da temperatura. A posição do máximo da banda segue a relação empírica,

$$\lambda_{\rm max} = 7 \ 03 \ d^{1,84}$$
 (2.15)

conforme demonstrado inicialmente por Mollwo-Ivey, onde d

representa a distância entre vizinhos mais próximos (par<u>â</u> metro da rede). A dependência com a temperatura da banda F é mostrada na figura 2.2 para o KBr. Com a queda da temperatura a banda F torna-se mais estreita e a posição do máximo de absorção desloca-se para comprimentos de onda menores.



FIGURA 2.2 - Variação da absorção F com a temperatura no KBr ⁽⁶⁾

A temperaturas altas, a largura da banda F varia com $T^{1/2}$, onde T é a temperatura absoluta, mas a baixas temperaturas, a largura se aproxima de um valor l<u>i</u> mite correspondente a alguns décimos de eV. Este compo<u>r</u> tamento é satisfatoriamente descrito pela seguinte equação: H = H_o $\begin{bmatrix} cotg (hw/2KT) \end{bmatrix}^{1/2}$ onde <u>H</u> é chamado meia-largura ("halfwidth") ou largura da banda a meia altura, sendo H_o a meia largura a T = OK, <u>w</u> a frequência de vibração no estado fundamental, <u>h</u> e <u>K</u> as constantes de Planck e Boltzmann, respectivamente.

II.4.1 - Agregados de centros F

Uma série de bandas, além da banda F, surgem quando cristais coloridos aditivamente são expostos a luz de comprimento de onda absorvida pelo centro F, a temperatura ambiente. Essas bandas também aparecem quan do cristais puros são irradiados prolongadamente COM raios X ou raios y. Estas bandas são causadas por agregados de centros F e possuem comprimentos de onda maiores do que o da banda F; a banda mais proeminente é devida aos centros M. O centro M é constituído de um par de vacâncias aniônicas vizinhas, na direção <110>, com dois elé trons, isto é, dois centros F vizinhos.

Iluminando-se um cristal colorido aditivamente, a temperatura próxima a ambiente, a primeira banda a surgir é a banda M. Após esta, aparecem as bandas R e N. O centro R é formado de um aglomerado de três centros F; estes ficam nos pontos de um triângulo equilátero, na direção <111>. O centro N é constituído por quatro centros F. As bandas R e N não aparecem sem as outras (F e M) estarem presentes, por isto é difícil obter informações destes centros individualmente. Vários trabalhos foram realizados para determinar a composição e pro-

cesso de formação do centro M. Pan e Luty $^{(38)}$ propuseram em 1978 um mecanismo de formação do centro M, que consiste das seguintes etapas: irradiando-se o cristal conte<u>n</u> do centros F com luz de comprimento de onda da banda F, ocorre a ionização do centro F e, o elétron é capturado por outro centro F, formando o centro F'. A vacância aniônica pode migrar e ser aprisionada em outros defeitos (no caso um centro F). O centro F', não sendo estável à temperatura ambiente, reemite o segundo elétron que reto<u>r</u> na à vacância, agora presa a outro centro, formando o centro M.

CAPÍTULO III

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

III.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS AMOSTRAS UTILIZADAS

Utilizamos em nossos estudos dois cristais: RbCl:OH 2080 e RbCl:OH 1200, fornecidos pelo Laboratório de Crescimento de Cristais da Universidade de Utah.

O cristal 2080 é ultrapuro com concentração da impureza \overline{OH} da ordem de 10^{18} \overline{OH} .cm⁻³. Uma análise do cristal 1200, através do seu espectro de absorção IV e UV, revelou entretanto que esta amostra além da impureza \overline{OH} (concentração da ordem de 10^{17} \overline{OH} .cm⁻³) apresenta também íons de cianeto (CN⁻). Como nada consta sobre a pr<u>e</u> sença de cianeto nas especificações fornecidas sobre o cri<u>s</u> tal, acreditamos que íons \overline{CN} tenham penetrado na amostra acidentalmente durante o crescimento. Embora o nosso objetivo seja o estudo do processo de fotodissociação \overline{OH} em r<u>e</u> lação a rede hospedeira, realizamos também experiências com esta amostra pois observamos que a presença de cianeto altera o processo de fotodissociação. Estes resultados serão apresentados e discutidos no capítulo IV.

III.l.l - Preparação das amostras

Para medidas ópticas, as :mostras foram clivadas, sempre a partir da região central do cristal, para evitar-se efeitos de superfície, com espessuras diferentes, de acordo com a experiência realizada.

Para medidas ópticas à baixas temperaturas, foram utilizadas amostras com espessuras entre 0,35 mm a 0,80 mm, dependendo da concentração de defeitos. Estas são presas ao porta-amostra do criostato (ítem III.2) por uma moldura de cobre, comprimida por quatro parafusos com molas (Figura 3-1).

Para medidas ópticas à temperatura ambiente, foram utilizadas amostras com espessuras entre 0,7 mm a 1,2 mm. Estas amostras são presas ao porta-amostra do espectrofotômetro (Ítem III.3) com fita adesiva apropriada.

Amostras de RbCl:OH com centros F ut<u>i</u> lizadas neste estudo foram coloridas aditivamente (ou com raios X; ítem III.5) em nosso laboratório ([†]tem III.6), se<u>n</u> do obtidas concentrações da ordem de 10^{17} F.cm³. Após a c<u>o</u> loração, as amostras foram mantidas no escuro, sendo manuseadas somente sob proteção de luz vermelha, a fim de evitar-se a ocorrência de processos fotoquímicos espúrios. Ainda, antes da realização de qualquer medida óptica, todas as amostras coloridas aditivamente foram submetidas a um aquecimento à temperatura de aproximadamente 600° C pelo período de um minuto e resfriamento rápido pelo contacto

·····

com duas placas de alumínio. Este procedimento assegura uma distribuição uniforme de centros F no cristal, uma vez que é trazida rapidamente à temperatura ambiente uma configuração de equilíbrio termodinâmico de centros F da temperatura do tratamento térmico, eliminando-se, assim,centros agregados e obtendo-se uma distribuição de Poisson de centros.

III.2 CRIOSTATO

As medidas ópticas à baixas temperaturas, foram realizadas utilizando-se um criostato óptico mod<u>e</u> lo 8 DT da "Janis Research Company, Stonehan Mass". Este instrumento foi projetado para operar com He e/ou N líquido, possuindo dois tanque concêntricos, sendo que, no mais externo, introduz-se N líquido e no mais interno, He ou N líquido, dependendo das condições experimentais. Neste trabalho operou-se com N líquido no tanque interno do criostato.

Em contato com o tanque de He ou N líquido, encontra-se uma ponta tubular de aço inox denominado "câmara do gás de troca" (Figura 3.1). Este conjunto tem por finalidade servir como chave térmica, possibilitando o contato térmico da amostra com o banho criostático (He ou N líquido), pela introdução de gás He na câmara de troca ou a interrupção da condução térmica entre o banho frio e a amos tra, retirando-se o gás de troca e efetuando-se alto vácuo dentro da câmara de troca.

O porta-amostra do criostato encontra-



câmara do gás de troca e porta amostra

FIGURA 3.1 - Câmara de Gás de Troca e Porta-Amostra. (1) En trada do Gás de Troca He; (2) Banho de Mitrogênio ou Hélio Líquido; (3) Tubo Concêntrico; (4) Câmara do Gás de Troca; (5) Elemento Aquecedor; (6) Folhas de Índium; (7)Termistor; (8) Termopar; (9) Máscara; (10) Amostra; (11) Bloco de Cobre; A - Geometria Paralela. B - Geometria Perpendicular. se fixo na extremidade inferior da câmara de gás de troca. Medida da temperatura na amostra é efetuada através de um termopar de cobre-constantan preso à extremidade superior do porta-amostra, com referência a O^OC obtida utilizando-se o "Ice point reference" da Kay Instruments". O valor da temperatura é obtido de um multímetro digital mod<u>e</u> lo 172 DMM da "Keithey Instruments", acoplado a um registr<u>a</u> dor HP 7100 BM que fornece as curvas de tempo <u>versus</u> temperatura.

Na extremidade superior do porta-amos tra há, ainda, um elemento resitor que é alimentado exter namente por um Variac, para quando for necessário aquecer a amostra controladamente. A temperatura na amostra pode, então, ser variada lenta ou bruscamente, de acordo com a tensão aplicada (2 a 10 volts) nos terminais do elemento resistor, combinada com a mudança na pressão do gás de troca, que no caso foi He.

A necessidade de medidas ópticas à baixas temperaturas deve-se ac fato da impureza OH fotodissociar-se efetivamente só à temperaturas abaixo de 100 K para alguns haletos alcalinos ⁽²¹⁾. Além disto, a maior parte dos produtos desta fotoreação é instável à temperatura ambiente.
III.2.1 - Tratamento térmico pulsado

Tratamentos foram utilizados com o objetivo de obter maiores informações sobre a cinét<u>i</u> ca de formação dos defeitos envolvidos na fotodissociação do Ion [OH].

O procedimento utilizado nos tratamentos térmicos realizados com as amostras dentro do criostato é chamado tratamento térmico pulsado. Este método consiste em aplicar pulsos de temperatura alternados, onde a temperatura máxima atingida num certo pulso é sempre maior do que a do pulso imediatamente anterior.

Para aplicação de um pulso de temperatura faz-se vácuo na câmara de troca e aplica-se uma tensão constante (idêntica para todos os pulsos) nos terminais do elemento resistor, fazendo com que a temperatura na amostra cresça de modo reprodutivo (aproximadamente linear), até atingir uma temperatura máxima (T_{max}) , onde se desliga a tensão aplicada e introduz-se gás He na câmara de troca. A temperatura decresce exponencialmente até estabilizar-se em um mínimo que é igual para todos os pulsos. Após cada pulso, o espectro de absorção óptica da amostra, na temperatura mínima (T_{min}) , é medido.Temse, então, a D.O. de qualquer ponto do espectro em função da T_{max}. A figura 3.2 mostra pulsos de temperatura caracteísticos das experiências com este tratamento.



FIGURA 3.2 - Pulsos de temperatura utilizados nas experiências de tratamento térmico pulsado.

III.3 MEDIDAS DE ABSORÇÃO ÓPTICA

Os espectros de absorção óptica foram obtidos com um espectrofotômetro CARY 17D, da"Varian" sendo observadas as regiões: de 400 nm a 700 nm (visível) e de 190 nm a 400 nm (UV).

A grandeza física importante a ser obtida destas medidas é a constante de absorção. O espectrofotômetro fornece a densidade óptica que está relacionada à constante de absorção da seguinte forma: o decréscimo da intensidade de luz ao atravessar a amostra é dada por:

$$I = I e^{-K \cdot d}$$

onde:

I_O = intensidade da luz incidente
I = intensidade da luz transmitida
K = constante de absorção
d = espessura da amostra

A densidade óptica (D.O.), por sua vez,

é definida como:

$$D.O. = \log_{10} \frac{I_o}{I}$$

de forma que a constante de absorção (K) pode ser escrita por:

$$K = \frac{2,303}{d}$$
 (D.O.)

A constante de absorção óptica normal<u>i</u> za, desta forma, os dados obtidos com relação ao efeito da espessura. O seu significado físico é o da energia absorvida pela amostra, sendo dada dimensionalmente em cm^{-1} .

III.4 CONCENTRAÇÃO DE DEFEITOS

A determinação da concentração de defeitos envolvidos neste estudo, foram obtidos utilizando-se a fórmula de Smakula ⁽⁶⁾:

N. f = constante.
$$\frac{n}{(n^2 + 2)^2}$$
. K. H

onde:

N = concentração de defeitos

f = intensidade de oscilador

n = Índice de refração do cristal para o máximo da banda

K = constante de absorção

H = largura da banda a meia altura

Para o RbCl, a concentração OH^- (T =

77 K) é obtida pela relação

.

$$N_{OH}^{-} = 0,775 \times 10^{17} \frac{D.O.}{d (cm)}$$
 (3.1)

e a concentração F (T = 300 K) por:

$$N_F = 0,101 \times 10^{17} - D.0.$$
 (3.2)
d (cm)

III.5 IRRADIAÇÕES

III.5.1 - Raios X

As irradiações X foram realizadas com um gerador da "Rigaku Denki", que permite operar com voltagens na faixa de 20 KV a 50 KV e intensidades de corrente na faixa de 2 mA a 50 mA. O tubo possui alvo de tungstênio e janela de Berílio.

As irradiações foram sempre efetuadas à temperatura ambiente nas condições 50 KV e 50 mA, a uma distância fixa da janela. Utilizou-se um filtro de alumínio de 0,75 mm de espessura, a fim de barrar os raios X de baixa energia, que causam danos apenas superficiais e,tam bém, para evitar a incidência de luz ambiente nas amostras quando as mesmas fossem recircidas do compartimento de irra diação. Ainda, quando possível, as amostras foram irradiadas no próprio porta-amostra, onde seriam realizadas as medidas de absorção óptica, a fim de evitar, também, incidência prolongada de luz ambiente.

O tempo de duração das exposições foi variável, conforme o objetivo da experiência. A distância entre a janela e a amostra foi mantida constante para todas as experiências.

III.5.2 - Ultravioleta

Para irradiações com luz UV, utilizouse: um conjunto de irradiação da "Bausch-Lomb" com lâmpada de Xe de 150 W, proveniente da Hanovia 901C-11 e fonte de alimentação; um conjunto de irradiação, também da "Bausch-Lomb", com lâmpada de Xe de 1000 W, filtro de água, refr<u>i</u> geração a ar e fonte de alimentação própria; um filtro de interferência da "Acton Research Corp." com comprimento de onda máximo da banda de 214 nm, transmissão máxima de 47% e largura da banda a meia altura de 58 nm. O sistema ópt<u>i</u> co completo para irradiação UV está esquematizado na figura 3.3.

As amostras foram mantidas à distância de 30 cm da lâmpada UV, para irradiações com lâmpada de Xe-1000 W e à 10 cm para irradiações com a lâmpada Xe-150W. Todas as irradiações UV foram realizadas com as amostras nos respectivos porta-amostras onde seriam realizadas as leituras de absorção óptica.



FIGURA 3.3 - Sistema para Irradiação UV

COMPANY OF BE ENERGIA DECLEAR SPI

III.6 COLORAÇÃO ADITIVA

Centros de cor podem ser criados em cristais haletos alcalinos por várias técnicas. Neste tr<u>a</u> balho utilizamos para obtenção de centros F a exposição a raios X, já mencionada no ítem III.5 e a coloração aditiva.

Um cristal contendo centros F é quimicamente equivalente a um cristal perfeito com um excesso estequiométrico de um metal alcalino. Assim, o processo de coloração aditiva consiste em aquecer o cristal em pr<u>e</u> sença de vapor de um metal alcalino até que o equilíbrio termodinâmico entre as duas fases (sólido e vapor) seja atingido.

O sistema por nós utilizado na coloração aditiva baseia-se no processo desenvolvido inicialmente por Van Doorn (39). Um esquema do sistema é apresent<u>a</u> do na figura 3.4.

O equipamento construído em nosso labo ratório consiste de um tubo de aço inox de 75 cm de altura e 6 cm de diâmetro externo, com uma flange com abertura para uma haste de sustentação do cone de coloração, também de aço inox, e que pode deslocar-se no interior do tubo. O tubo, por sua vez, pode deslocar-se no interior de um forno, podendo controlar-se tanto a temperatura do cris~ tal, quanto a do metal alcalino e dos vapores do mesmo па parte superior do tubo, onde existe uma serpentina COM circulação contínua de água para refrigeração do tubo.



FIGURA 3.4. Sistema de Coloração Aditiva. 1) Haste de sustentação do cone. 2) Entrada de Nitrogênio (manômetro). 3) Válvula de conexão com a bomba de vácuo. 4) Conexão da bomba de vácuo. 5) Serpentina para refrigeração(com água). 6) Cone de coloração. 7) Forno. 8) Termopar para controle de temperatura do cristal. 9) Cilindro de Níquel. 10) Porta-amostra de Níquel. 11) Suporte. 12) Potássio metálico. 13) Termopar para controle da temperatura do potássio.

O procedimento para a experiência é o seguinte: no fundo do tubo coloca-se o metal alcalino com o qual se fará a coloração, após ter-se removido a super fície do mesmo e lavado com hexano. Sobre o metal alcalino é colocado um anteparo de aço inox e, sobre este, um cilin dro de níquel com uma tampa superior na forma de um cone, dentro do qual se coloca o cristal envolto em uma folha de níquel. Fecha-se hermeticamente o tubo de coloração, fazendo-se vácuo mecânico no sistema. Inicia-se, então, o aquecimento do tubo após ter-se injetado no mesmo uma pressão apropriada de nitrogênio.

O funcionamento do sistema é baseado no princípio do "heat pipe" (40), ou seja: c metal alcalino na parte inferior do tubo, ao entrar em contato com a zona quente do forno, começa a evaporar-se. Os vapores se elevam atravessando a zona onde se encontra o cristal e condensam-se ao atingirem a superfície fria do cone de colora ção, caindo, então, na forma de gotas sobre o cone de níquel, voltando à região quente na parte inferior do tubo. onde evaporam novamente. Desta forma se estabelece um equi líbrio dinâmico de vapor de metal alcalino na região onde se encontra o cristal, separada à altura do cone, da região superior onde se encontra o gás nitrogênio injetado no sistema. A linha divisória entre a região de vapor metálico e gás nitrogênio ocorre no nível onde a temperatura é equivalente ao "ponto de orvalho" do vapor de potássio.

Este arranjo permite um controle sobre a pressão de vapor do metal através do controle da pres-

ŗ

ŝ

N. A. K.

são do gás nitrogênio (monitorado externamente por um manô metro na entrada de gás no sistema), uma vez que deve exis tir uma pressão de equilíbrio e que a separação dos gases
é completa, exceto, talvez, em uma pequena região de conta to entre eles.

Ao término do processo, resfria-se rapidamente o cristal, retirando-se o tubo do forno e inserindo o mesmo num banho de nitrogênio líquido.

A faixa de temperatura para a colora ção aditiva de haletos alcalinos é limitada pela temper<u>a</u> tura de fusão do cristal a ser colorido e pela temperatura na qual a formação de agregados é favorecida. A tab<u>e</u> la III fornece os dados experimentais obtidos do processo de coloração aditiva do RbCl.

TABELA III

Coloração aditiva do RbCl

Tfusão	≖ 715 [°] C
metal utiliza	do para coloração = pot ⁻ ssio
^T cristal	= 625 [°] C
^T potãssio	= 550 [°] C
^p nitrogênio	= 0,7 Kgf/cm^3
Duração do pr	ocesso = 10 a 20 horas

CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados e dis cutidos os resultados experimentais obtidos a partir do estudo dos defeitos produzidos por radiação de baixa energia em cristais de cloreto de rubídio, dopados com a impureza OH, utilizando-se a técnica de absorção óptica.

Conforme mencionado no Capítulo III, utilizamos em nossos estudos dois cristais: RbCl:OH 2080 e RbCl:OH 1200, sendo que a amostra 1200 apresenta fons CN (cianeto), além da impureza OH . Para análise dos resultados da amostra 2080 adotamos o seguinte procedimento: comparação de nossos resultados com os dados existentes na literatura sobre o processo de fotodissociação OH no KCl, visando o estudo da influência do parâmetro da rede sobre o processo.

Em relação à amostra 1200, realizamos uma comparação direta dos resultados obtidos nas duas amostras (2080 e 1200) a fim de determinarmos a influência da presença de cianeto no comportamento da impureza OH no RbCl.

Para facilitar a discussão dos resultados, apresentaremos, inicialmente, os resultados obtidos na amostra de cloreto de rubídio dopada somente com íons

IV.1 FOTODISSOCIAÇÃO OH NO RbC1 - 2080

A absorção relativa à impureza OH no o RbCl ocorre em 2137 Å, próxima à absorção eletrônica fun damental. É uma banda larga e sem estrutura que apresenta um pequeno "estreitamento" à baixas temperaturas (Figura 4.1).

Irradiando-se a transição responsável pela banda \overrightarrow{OH} à temperatura de 77 K, observamos o descrés cimo da mesma e o simultâneo crescimento de duas novas bandas em 1930 Å e 2450 Å, que de acordo com a equação de fotodissociação

 $OH^{-} + hv_{OH^{-}} \longrightarrow H^{O}_{i} + O^{-}$ (4.1)

são atribuídas a centros U₂ (átomos de hidrogênio intersticiais) e a centros substitucionais de oxigênio. O espectro de absorção obtido após a fotodissociação é mostrado na figura 4.2.

Mesmo com períodos de irradiação prolon gados, não é possível obter centros $U_2 e$ \bigcirc isoladamente no cristal, pois uma concentração de centros \bigcirc H sempre permanece na amostra. Isto ocorre porque, após ser atingida uma determinada concentração de defeitos $U_2 e$ \bigcirc tor



FIGURA 4.1. Banda de absorção eletrônica característica da impureza OHT no RBC1 - 2080 a temperatura ambiente e a 77 K.



FIGURA 4.2. Espectro de absorção óptica do crista <u>Rb</u>Cl-2080, mostrando os produtos primários da fotodissociação <u>OH</u> após diferentes períodos de irradiação UV na banda <u>OH</u> a 77 K.

na-se grande a probabilidade de recombinação, passando a existir dois canais competindo: um levando à dissociação e outro à recombinação (equilíbrio dinâmico).

Na figura 4.3 mostramos a variação da densidade óptica dos defeitos OH, $U_2 e O$ em relação ao tempo de irradiação UV. Na figura 4.3 b mostramos os gráficos das variações na densidade óptica dos centros OH versus as variações nas densidades ópticas dos centros $U_2 e O$.

Destes resultados, com base na fórmula de Smakula, calculamos os valores da intensidade de oscil<u>a</u> dor (número f) para os dois centros, a partir de um valor conhecido de intensidade de oscilador do centro OH no RbCl. Os valores obtidos encontram-se na tabela IV, bem como a "largura da banda a meia altura" (H) para cada abso<u>r</u> ção, também calculadas por serem necessárias na determinação de f.

TABELA IV. Características dos defeitos observados na, fotodissociação OH⁻ no RbCl - 2080.(T=77K)

Defeito	ο λ (λ)	E(eV)	H (eV)	f
OH	2137	5,80	0,60	0,17 (17)
U2	2450	5,06	0,36	0,20
0	1930	6,42	0,30	0,12



FIGURA 4.3. Fotodissociação OH no RbC1-2080 à 77K. a) Variação da D.O. das bandas de absorção OH, $U_2 \in O^-$, versus o tem po de irradiação UV. b) Decréscimo da banda de absorção OH^- versus o acréscimo da bandas de absorção $U_2 \in O^-$, respectiva mente.

;

IV.2 TRATAMENTO TERMICO NO RbC1 - 2080

A fim de observarmos os produtos secun dários da fotodissociação OH no RbCl, realizamos um estudo do comportamento termodinâmico dos defeitos produzi dos pela radiação de baixa energia, através da aplicação de pulsos de temperatura. Este procedimento, já descrito no capítulo III, é chamado tratamento térmico pulsado. Dos resultados obtidos, construímos as figuras 4.4 e 4.5, que serão analisadas a seguir.

Na faixa de 70 a 100K, observamos que os centros \overrightarrow{OH} e os defeitos primários de sua fotodissociação, os centros U_2 e \overrightarrow{O} , permanecem estáveis, não sendo verificadas alterações no espectro de absorção da amostra.

Na região de 100 a 120 K, temos a extinção dos centros U2, um decréscimo da absorção devida aos centros 0 e a formação de uma absorção larga е visível do espectro. A estrutuassimétrica na região ra e posição espectral desta banda permite identificá-la como devida a centros H₂0 substitucionais. A figura 4.6 mostra as variações espectrais da amostra com a apli cação dos pulsos de temperatura na faixa de 100 a 120 K.A comparação da curva de extinção dos centros U₂ e a curva de formação dos centros $[H_2O]$ mostra que a razão máxima de destruição dos centros U, coincide com a razão máxima H,0 . de formação dos centros Este aspecto, aliado ao decaimento observado da banda 💽, permite propormos



FIGURA 4.4. Estabilidade térmica dos produtos primários e secundários da fotodissociação OH^- no RbC1-2080. Alteração obser vada devido a aplicação de pulsos de temperatura (tratamento térmico pulsado), na faixa de 77 a 130 K.



FIGURA 4.5. Estabilidade térmica dos produtos primários e secundários da fotodissociação OH⁻ no RbC1-2080. Alteração obser vada devido a aplicação de pulsos de temperatura (tratamento térmico pulsado) na faixa de 130 a 250 K.

FIGURA 4.6. Espectro de absorção óptica do RbCl-2080,mos trando a destruição térmica de centros U_2 e a simultânea produção de centros H_2O^- .

qualitativamente a seguinte reação para formação de cen-
tros
$$H_2^{O}$$
:
 $2H_1^{O} + O^{-} + KT \longrightarrow H_2^{O}$ (4.2)

Nesta faixa de temperatura, observamos ainda, um aumento na absorção OH, indicando a ocorrên cia de recombinação dos centros H_1^0 , instáveis térmicamen te, e seus anti-centros O. Segundo Kostlin ⁽¹⁴⁾, a recombinação de centros U_2 e O produzem moléculas OHexcitadas que se desexcitam por emissão luminescente.

Na região de 120 a 150 K, temos uma faixa de estabilidade térmica, não sendo observadas alte rações nas absorções relativas aos centros $|H_2O|$, |O|е Юн-1, resultantos da etapa anterior. Entretanto, para temperaturas superiores a 150 K, observamos, novamente, o crescimento da banda H₂O e o decréscimo da banda 0 até aproximadamente 200 K. A questão imediata após este resultado é: porque mais centros H_O são formados após este período de estabilidade ? Tal comportamento pode ser explicado se considerarmos a existência de centros U_{2x} mencionados no capítulo II. Estes centros apresentam uma configuração intermediária na formação de centros н,0

No KCl⁽³¹⁾, o centro H_2O apresen ta dois estágios de formação: de 100 a 120 K, onde se tem a produção de centros H_2O e U_{2x} a partir da destrui-

ção térmica de centros U_2 ; e de 120 a 210 K, onde se tem, novamente, a produção de centros H_2O , mas, agora, a partir da destruição térmica de centros U_{2x} , instáveis a partir de 130 K.

Mais precisamente, a destruição térmi ca dos centros U_{2x} pode ocorrer por dois mecanismos ⁽³¹⁾:

$$\begin{bmatrix} OH^{-} & H_{1}^{O} \end{bmatrix} + KT \longrightarrow H_{2}O^{-} \qquad (4.3)$$

$$\begin{bmatrix} OH^{-} & H_{1}^{O} \end{bmatrix} + KT \longrightarrow H^{-} + (OH)_{1}^{O} \qquad (4.4)$$

O átomo de hidrogênio intersticial aprisionado pelo íon OH, por ativação térmica, migra em direção à vacância do íon OH, podendo ser capturado por este, produzindo diretamente o centro H_2O ou, então, capturar o elétron deste íon, trocando de posição com o mesmo localizando-se na vacância, dando origem a um centro U e uma molécula OH^O em uma posição intersticial. Centros OH_i^O não são facilmente detectados por absorção ótica, mas os centros U em haletos alcalinos apresentam absorções próximas à absorção OH (no RbCl $\lambda_{II} = 2280 \text{ Å}$).

Após a aplicação do pulso de 190 K, observamos um alargamento da banda OH, indicando a presença de uma nova absorção. Devido ao fato de termos uma concentração de defeitos OH elevada, nesta amostra, torna-se difícil a observação de absorções próximas **ā** absorção OH; entretanto, com base nas considerações acima, podemos afirmar que o alargamento observado indica a presença de centros U. Assim, embora não tenha sido po<u>s</u> sível registrar a presença de centros U_{2x} por absorção ćt<u>i</u> ca, provavelmente, porque a interação spin-órbita é muito pequena nos cloretos ⁽³¹⁾, concluimos, baseados nos resultados obtidos em relação à formação de centros H_2^{0} e U, que os centros U_{2x} no RbCl são produzidos à temperatura de 110 K, coincidindo com a razão de máxima destruição dos centros U₂, e tornam-se instáveis térmicamente a temperaturas superiores à 150 K, dando origem a centros adicionais de H_2^{0} .

Conforme já mencionado, nesta faixa de temperatura (150 a 200 K), observamos, ainda, o decaimento da absorção \boxed{O} . A curva de decaimento destes centros apresenta um comportamento inverso em relação à curva de formação de centros $\boxed{H_2O}$, o que nos leva a considerar a possibilidade de que centros \boxed{O} também contribuam para a formação de centros $\boxed{H_2O}$, a partir da destruição térmica de centros $\boxed{U_{2x}}$. Propomos, então, um terceiro mec<u>a</u> nismo para a destruição térmica dos centros $\boxed{U_{2x}}$:

$$x\left[OH^{-} \cdot H_{1}^{O}\right] + KT \longrightarrow x\left[OH^{-} + xH_{1}^{O}\right]$$
 (instance)
(4.5)

sendo que,

$$1 0^{-} + 2 H_{1}^{0} \longrightarrow H_{2}^{-}$$
 (4.6)

Somando-se as equações (4.5) e (4.6), temos:

$$x \left[OH^{-} \cdot H_{1}^{O} \right] + y \left[O^{-} \right] + KT \longrightarrow x \left[OH^{-} \right] + y \left[H_{2}O^{-} \right]$$

$$(4.7)$$

Devido ao equilíbrio na concentração de defeitos OH, a absorção OH permanece praticamente constante (Figura 4.5).

Acima de 200 K, observamos a destruição térmica dos centros H_2O e o aparecimento de Centros F, sendo que, durante este processo, as concentrações OH e O permanecem inalteradas. A destruição térmica de centros H_2O pode ocorrer por três mecanismos ⁽³¹⁾:

$$H^{-} + OH_{i}^{O} \qquad (4.8)$$

$$H_{2}^{-} + KT \qquad \stackrel{e^{-}}{\longrightarrow} H^{-} + H_{i}^{O}(\text{instavel}) + OH_{i}^{O} \qquad (4.9)$$

$$OH^{-} + H_{i}^{O}(\text{instavel}) \qquad (4.10)$$

sendo que a probabilidade de ocorrência de cada processo sofre influência da rede cristalina, onde o processo se desenvolve. Por exemplo, no KCl e no KBr as equações de destruição dos centros $[\frac{\mu_2 0}{2}]$ são dadas respectivamen te ⁽³¹⁾ por:

$$7 \text{ H}_2^{\circ} + \text{KT} \longrightarrow 4 \text{ H}^- + 1 \text{ e}^- + 2 \text{ OH}^- + 5 \text{ OH}_i^{\circ} + 3 \text{ H}_i^{\circ} (\text{movel})$$
 (4.11)

$$1 H_2^{\circ} + KT \longrightarrow 1e^{\circ} + 1 H_1^{\circ}(capturado) + 1 (OH)_1^{\circ}$$
(4.12)

Como não pudemos observar com boa resolução a abscrção devida aos centro: U, pois, conforme men cionado, a concentração OH nesta amostra é muito elevada, não foi possível propormos uma equação para a destruição térmica dos centros H_20^- . Entretanto, como a razão máxima de destruição destes centros é coinc⁴dente com a razão máxima de formação dos centros F (Figura 4.5) podemos propor que o mecanismo dado pela equação (4.9) é o mais provável.

IV.3 FOTODISSOCIAÇÃO OH NO RbC1 - 1200

Na amostra RbCl 1200, na região espe<u>c</u> tral do UV, observamos, à temperatura ambiente, além da absorção característica da impureza \overrightarrow{OH} em 2137Å uma segunda absorção em 1960 Å de origem inicialmente desconhecida. Obtivemos, então, o espectro infravermelho desta mesma amostra, à temperatura ambiente, a fim de ver<u>i</u> ficarmos a presença de outras impurezas, além de ions \overrightarrow{OH} . De fato, observamos uma estreita banda de absorção centrada em 2165 cm⁻¹ (-4,6 µm). Esta região espectral é característica de impurezas de cianeto (CN⁻).

Conforme mencionado no Capítulo III, deve ter ocorrido a contaminação da amostra acidentalmente durante o seu crescimento. Devido ao fato da presença de íons \boxed{CN} alterar o processo de fotodissociação \boxed{OH} (ítem IV.3.3), consideramos a hipótese da ocorrência de interação entre estas duas impurezas. A fim de estabelecermos referências para a análise da hipótese proposta, apresentamos a seguir algumas considerações sobre a impureza \boxed{CN} em cristais haletos alcalinos.

CN_ IV.3.1 - Impureza

O espectro de absorção eletrônico de cristais KCl, RbCl e NaCl, dopados com fons \boxed{N} , consiste, a baixas temperaturas (T = 77 K), de várias bandas de absorção com formas semelhantes, localizadas na região da absorção eletrônica fundamental do cristal⁽⁴¹⁾. A tabela V, fornece as energias dos máximos de absorção das respectivas bandas, características de centros \boxed{CN} em cristais KCl e RbCl.

TABELA V. Energias E_n (eV) dos máximos de absorção dos centros CN em cristais haletos alcalinos.

	Eo	E ₁	£2	E ₃	
KCl	6.895	7.080	7.260	7.430	
RbC1	6.794	6.986	7.180	-	

As energias observadas para as bandas E_0 apresentam boa concordância com as energias calculadas pela equação de Hilsch e Pohl, derivada do modelo de transferência de carga no estudo do espectro excitônico de haletos alcalinos ⁽⁴¹⁾.

Heyden e Fischer ⁽⁴¹⁾ explicam a natureza das transições UV dos centros (N), baseados nas seguintes considerações: excitação do estado de menor energia remove um elétron da molécula (N), podendo ocor rer a transferência do elétron para cátions vizinhos na re

de. A perda de um elétron de valência enfraquece a ligação química da molécula, dando origem à uma alteração de uma quantidade δ da distância nuclear. Isto ...va, simultaneamente, à alteração do potencial de vibração molecu lar. Este modelo prevê, portanto, absorção óptica próxima ao limite fundamental, devido a uma excitação do tipo-exciton e simultânea criação de n = 0,1,2, ... quanta de vibração molecular.

Baseados nestas considerações, Heyden e Fischer⁽⁴¹⁾ obtiveram resultados satisfatórios na explicação do espectro óptico de cristais de sódio, dopados com ions [N], e do espectro óptico de KCl:CN e RbCl:CN à temperatura de 78 K.

O espectro vibracional de centros CN no KCl, à temperatura ambiente, consiste de uma banda de absorção com estrutura dupla característica, em torno de 4,8 µm. Além desta absorção, tem-se uma absorção secundária (em torno de 2,5 µm), de forma idêntica à absorção fundamental, mas cuja intensidade é aproximadamente duas vezes menor do que a primeira. Narayanamurti e Pohl ⁽⁴²⁾ consideram que estas absorções são devidas à excitação óptica do modo vibracional de estiramento e simultânea excitação, ou de-excitação, de um estado rotacional da molécula CN. Os fors CN no KCl, a temperaturas maio res do que 60 K, apresentam pequenas barreiras à rotação; a influência do potencial cristalino torna-se desprezível à T > 60 K, isto é, os ions [CN] comportam-se como បា çás diluído de moléculas livres. Abaixo de 60 K, o campo

cristalino torna-se "perceptível" à molécula e, entre os dois máximos observados a altas temperaturas, surge uma estreita absorção, que cresce rapidamente com o decréscimo da temperatura, devida à libração da molécula.

O espectro de centros $\[mathbb{CN]$ no RbCl é qualitativamente similar ao KCl⁽⁴³). Devido ao fraco potencial cristalino, a absorção de estiramento no RbCl consiste, a altas temperaturas, de um espectro rotacional-vibracional de baixa resolução, devido aos níveis do rotor "perturbado". Mesmo a 80 K, tem-se absorções largas. A baixas temperaturas, as moléculas $\[mathbb{CN]$ realizam movimentos de libração com frequências da ordem de $19 {
m cm}^{-1}$.

IV.3.2 - Interação das impurezas OH e CN

Quando impurezas moleculares são introduzidas em cristais iônicos, estas bandas tendem a ocupar posições isoladas em sítios substitucionais, se suas dimensões forem compatíveis com as dimensões dos elementos constituintes da rede matriz. É o caso de fons \overline{CN} : \overline{OH} introduzidos em haletos alcalinos.

Devido à alteração da massa que se substitui e da mudança na constante de ligação destas moléculas em posições substitucionais, modos localizados cu de ressonância podem ser introduzidos no "gap" energético do cristal. Além destes modos vibracionais,outros graus de liberdade do defeito molecular dão origem a modos rotacionais e libracionais fortemer+e localizados. A altura da barreira ou potencial rotacional, devido à int<u>e</u> ração da molécula com ions vizinhos da rede, determina os tipos de modos localizados. Se o potencial é pequeno ou comparável à energia rotacional da molécula, tem-se como modelo o rotor "quase" livre (pequena perturbação). Com o aumento da barreira de potencial, a energia entre os ní veis rotacionais também aumenta sendo a rotação e libração mais intensamente perturbadas, apresentando amplitu des angulares decrescentes e frequências crescentes.

Conforme já mencionado, a alteração do processo de fotodissociação OH devido à presença de fons CN, levou-nos à hipótese de haver uma inter<u>a</u> ção entre estes dois defeitos. Para explicarmos esta i<u>n</u> teração, consideramos um modelo onde teríamos um agregado composto pelas duas impurezas, OH e CN, em posições substitucionais próximas.

O movimento de "estiramento" da molécula $\boxed{\text{CN}}$ no RbCl produz uma absorção larga com frequência característica em 2075 cm⁻¹ (temperatura ambiente)⁽⁴³⁾. De acordo com nosso modelo, existiria uma forte interação dipolar entre as moléculas OH⁻ e CN⁻ em posições substitucionais próximas, a qual poderia alterar o potencial rotacional da molécula $\boxed{\text{CN}}$. Pode-se supor, portanto, que os defeitos $\boxed{\text{CN}}$, associados a defeitos $\boxed{\text{OH}}$, tornar-se-iam mais fortemente localiza-

dos em suas orientações, causando o deslocamento das frequências características dos modos vibracionais para valores maiores. Estas considerações explicariam a absorção centrada em 2165 cm⁻¹, observada à temperatura ambiente, na amostra 1200.

De forma análoga, a absorção eletrônio ca observada à temperatura ambiente em 1960 A, pode ser considerada como uma transição eletrônica do agregado [OH]. [CN], análoga à transição eletrônica do [OH] iso lado, onde o efeito primário da absorção de um fóton é o da transferência de carga de um elétron do ion [OH] para um átomo alcalino vizinho mais próximo ou mecanismo de absorção por transferência de carga.

Baseados, então, neste modelo, analis<u>a</u> mos os resultados obtidos na fotodissociação e demais tratamentos realizados com a amostra 1200 e comparamos estes resultados com os obtidos no RbCl 2080.

IV.3.3 - Fotodissociação

ž

A baixas temperaturas, a absorção em O 1960 A, considerada como devida a agregados [OH]. [CN], apresenta uma largura de linha estreita e um deslocamento do seu máximo de absorção para 1940 A. A figura 4.7 mostra o espectro de absorção UV obtido à temperatura ambien te e a 77 K.

FIGURA 4.7. Bandas de absorção eletrônica características do agregado OHT . CN e da impureza OHT no RbC1-1200, a tem peratura ambiente e a 77 K.

Independente da presença dos agre gados, irradiamos esta amostra nas mesmas condições de irradiação da amostra 2080. Observamos, neste processo o decréscimo da banda OH, bem como da banda relativa aos agregados, e o simultâneo crescimento de duas novas bandas: uma em 2450 A, característica de centros U₂ no RbCl, e outra em 2040 A, de origem desconhecida (Figura 4.8). Note-se que a banda centrada em 2040 A não é devida a centros 0, pois, de acordo com as experiências na amostra 2080, estes centros apresentam absorção característica em 1930 A. Para facilitar a exposição dos resultados, chamamos esta nova absorção em 2040 A de banda х.

Fazendo-se um gráfico das variações das densidades ópticas dos defeitos envolvidos <u>versus</u> o tempo de irradiação, pudemos observar a proporção de formação e destruição de cada defeito (Figura 4.9). As curvas dos centros \overrightarrow{OH} e centros agregados $\begin{bmatrix} OH \\ . \\ CN \end{bmatrix}$ apresen tam um comportamento inverso em relação às curvas dos centros U_2 e X. De forma qualitativa, podemos, inicialmen te, representar o processo observado pela equação:

 $OH^{-} + [OH^{-} \cdot CN^{-}] + hv_{OH} \longrightarrow U_2 + X (4.13)$

A destruição dos centros OH^{-} e a pr<u>e</u> sença de centros U₂ após a irradiação, indicam a ocorrência de um processo de fotodissociação semelhante ao obse<u>r</u> vado na amostra 2080, apesar da presença de impurezas

FIGURA 4.8. Espectro de absorção óptica do cristal RbC1-1200, mostrando os produtos primários da fotodissociação OH-, após diferentes períodos de irradiação UV na banda OH- a 80 K.

FIGURA 4.9. Fotodissociação OH no RbC1-1200 a 80 K. Variação da D.O. das bandas de absorção $\begin{bmatrix} OH^- & CN^- \end{bmatrix}$, $OH^- & U_2 = O^-$, versus o tem po de irradiação UV.

 \overline{CN} . De acordo, então, com a equação de fotodissocia ção (4.1), a cada \overline{OH} destruído corresponderá a forma ção de um centro U_2 e um centro \overline{O} . Contudo, não foi observado, nesta amostra, a banda de absorção caracte rística de centros substitucionais de oxigênio, mas, somente, uma banda de origem desconhecida, centrada em 2040 Å, ou banda X.

Duas hipóteses são propostas para explicarmos este fato: a primeira seria a presença da absorção [OH]. CN] em 1940 Å não possibilitar a observação da banda devida aos centros O] em 1930 Å. O espectrofotômetro não apresenta resolução suficiente para separar estas duas bandas. A segunda hipótese seria a pre sença inicial de íons CN] afetar o processo de foto dissociação, causando uma perturbação nos produtos da reação, de forma que os centros O] tivessem sua absorção característica alterada.

Um estudo do espectro de absorção obt<u>i</u> do elimina a primeira hipótese, pois, mesmo não existindo resolução suficiente para separar as duas absorções, s<u>a</u> bemos, das experiências com a amostra 2080 (Figura 4.2), que a banda \bigcirc correspondente ã banda U₂ observada (Figura 4.8), apresentaria intensidade de absorção sufic<u>i</u> ente para provocar uma distorção no espectro devido a sua composição com a absorção dos agregados. Além disto, esta hipótese explica, apenas, a ausência da absorção \bigcirc , não fornecendo dados quanto a presença da banda X. Isto, po<u>r</u>
tanto, nos leva à verificação da segunda hipótese

Conforme mencionado, a segunda hipót<u>e</u> se propõe que os centros \boxed{O} s^ejam perturbados pela pr<u>e</u> sença de ions \boxed{CN} , dando origem a uma nova absorção, ou à banda X. No estudo desta possibilidade, duas questões são inicialmente levantadas: por que os centros U₂, também produtos da fotodissociação \boxed{OH} , não são igualmen te perturbados por ions \boxed{CN} ? E Caso ocorra este efeito que tipo de interação ocorre entre os centros \boxed{O} e ions \boxed{CN} ?

Uma análise detalhada da banda U2, baseada em um estudo comparativo da absorção característi ca deste defeito nas duas amostras (1200 e 2080), revelou que, além de apresentarem mesma posição, ambas apresenmesma "largura a meia altura" tam, aproximadamente, a (1200 H = 0,378 eV; 2080 H = 0,36 eV). Isto implica que a presença de impurezas <u>CN</u> praticamente não perturba a transição característica dos defeitos de hidrogênio. Con tudo, a análise da concentração de centros U2, obtidos após a irradiação da amostra 1200, mostrou que a concen tração destes defeitos é maior do que a concentração de de feitos OH inicial. Calculando-se as áreas sob as ban das U_2 e OH pelo método da pesagem, obtivemos as con centrações correspondentes através da seguinte fórmula:

N = C.
$$\frac{n}{(n^2 + 2)^2}$$
. $\frac{\text{área}}{f}$ (4.14)

onde, N é a concentração de defeitos,

r · · · ·

C è uma constante de proporcionalidade,

n é o índice de refração no máximo da banda,

f é a intensidade de oscilador da transição.

A partir desta relação, verificamos que a concentração de centros U₂ é, aproximadamente, duas vezes maior do que a variação da concentração OH . Qual a origem destes centros adicionais de hidrogênio ? A hipótese mais viável é que estes centros U₂ adicionais sejam pro-OHdutos da fotodissociação dos centros pertencentes ao agregado OH . CN . Isto implica na ocorrência de dois processos de fotodissociação simultaneos: um devido ao OH não perturbado,que tem como produtos centros U2 e 0, e outro devido ao OH pertencente ao agregado OH. CN, que tem como produtos centros U_2 e defei tos X. Ocorrem, então, na amostra 1200, as reações descritas pelas equações abaixo:

 $\begin{bmatrix} OH^{-} + hv_{OH} & \xrightarrow{T= 80K} & U_2 + O^{-} \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} OH^{-} \cdot CN^{-} \end{bmatrix} + hv_{OH} & \xrightarrow{T= 80K} & U_2 + X$ (4.15)

Estas considerações respondem a primeira ques tão levantada e, também, nos faz retomar a primeira hipótese proposta sobre a ausência dos centros substitucionais de oxigênio. Como somente metade da concentração U_2 é devida ao processo de fotodissociação que tem centros O como produto, devemos rever as considerações feitas sobre a intensidade de absorção esperada para a banda O. Comparando-se, novamente, as figuras 4.2 e 4.8, mas considerando somente a metade da concentração U₂, observamos que a intensidade da banda O esperada reduz-se consideravelmente, sendo possível a ocorrência de composição das duas absorções, sem que seja observada alteração significativa no espectro final.

O fato de não conhecermos a dinâmica do processo de fotodissociação do agregado [OH]. [N], dá margem a várias interpretações quanto à configuração do defeito X e, consequentemente, quanto ao tipo de interação entre os fons de oxigênio resultante da fotodissociação do OH] pertencente ao agregado e fons [N]. Contudo, de acordo com os resultados experimentais obtidos e o modelo proposto no ítem IV.3.2, consideramos, inicialmente, duas possibilidades que serão apresentadas a seguir.

Os centros substitucionais de oxigênio, resultantes da fotodissociação dos ions OH pertencentes ao agregado, podem ser perturbados pela presença de ions ON, em sitios vizinhos próximos, resultando no complexo [O. ON, que apresentaria a absorção característica em 2040 Å, ou seja, a banda X, onde a reação de fotodissociação seria descrita por:



A segunda hipótese é que, no processo

de fotodissociação, o defeito o adquira energia cinéti ca suficiente para mover-se na direção do ion CN, le vando à formação de uma molécula OCN (cianato), sendo, neste processo, liberado um elétron que poderia ser captu rado por um dos defeitos ou mesmo por ions da rede. Neste caso, o processo de fotodissociação seria descrito por:

$$\begin{bmatrix} OH^{-} & CN^{-} \end{bmatrix} + hv_{OH^{-}} \longrightarrow H_{i}^{O} + OCN^{-} + e^{-}$$
(4.17)

Devido ao fato da disponibilidade de dados sobre o espectro UV de cristais iônicos dopados com fons OCN ser muito pobre, não pudemos obter uma identi ficação na literatura sobre a energia característica des te defeito. De forma análoga, por não terem sido realiza dos, até o presente, estudos com cristais dopados com im-~ [CN] simultaneamente, não pudemos obter OH_ purezas dados que nos permitissem concluir preliminarmente, quanto a proposta do complexo Assim, optamos pe . la realização de novas experiências que nos permitissem obter dados adicionadis sobre a influência de fons CN no processo de fotodissociação. Nos itens a seguir, apresentaremos os resultados obtidos no tratamento térmico e colo ração da amostra 1200.

Finalizando esta discussão apresentamos a tabela VI a qual resume as características das absorções observadas no processo de fotodissociação da amostra 1200.

Defeito	ο λ (Å)	E (eV)	H (eV)
	1940	6,39	0,16
x	2040	6,08	0,18
^U 2	2450	5,06	0,378

TABELA VI. Características dos defeitos observados na fotodissociação OH⁻ no RbCl-1200 (T= 80K)

IV.3.4 - Tratamento térmico

Através de procedimento análogo ao des crito no Ítem IV.2, estudamos as reações secundárias do processo de fotodissociação na amostra 1200. Os resultados obtidos são mostrados na figura 4.10.

Na região de 80 a 120 K, observamos, de forma análoga à amostra 2080, a destruição térmica dos centros U₂ com razão máxima de destruição à 110 K. Simu<u>1</u> taneamente, ocorre o decaimento da absorção característica de centros X e o crescimento da absorção relativa aos agregados, além da formação de uma pequena absorção na região visível.

Este resultado pode ser explicado considerando-se, inicialmente, que centros U₂ instâveis sejam



FIGURA 4.10. Estabilidade térmica dos produtos primários e secundários da fotodissociação OH⁻ no RbC1-1200. Alterações obse<u>r</u> vadas devido a aplicação de pulsos de temperatura (tratamento térmico pulsado) na faixa de 80 a 150 K.



capturados por centros X, levando à reconstituição do com-Dlexo OH . [CN] . Quanto à absorção na região visivel, não pudemos identificá-la nesta etapa do tratamento térmico; entretanto, a temperaturas maiores torna-se evidente, por sua estrutura e energia característica, que esta absorção é devida a centros H₀0]. De fato, pros seguindo o tratamento térmico, observamos um comportamento semelhante à amostra 2080, isto é, a partir de 150 K, tem-se, após um periodo de estabilidade, a formação de centros adicionais de [H_O] Conforme mencionado ante-. riormente, este comportamento deve-se a formação de centros U_{2x}, cuja absorção não pode ser observada provavelmente devido ao fato da interação spin-órbita ser pequena nos cloretos⁽³¹⁾. Contudo, devido a baixa concentranesta amostra, a presença de cenção de impurezas OH tros U_{2x} pode ser confirmada indiretamente por dois pro dutos resultantes de sua destruição térmica - centros U e - conforme as equações (4.3) e (4.4). (Fi centros [H_0] gura 4.11).

Estes resultados levam~nos a propor que a configuração para o defeito X é:

$$X = \left[\begin{array}{c} O \end{array} \right] . \quad CN \qquad (4.18)$$

A hipótese de que o centro X fosse uma molécula OCN foi excluída devido ao processo de recombinação observade. Este processo, no caso, implicaria na quebra da ligação O - CN da molécula de cianato, (devido a energia térmica fornecida no tratamento térmi



FIGURA 4.11. Espectro de absorção óptica do RbC1-1200, mostrando a produção simul tânea de centros $U \in [H_2^0]$, resultantes da destruição térmica de centros U_{2x} .

71.

co), e, ainda, à captura de um átomo de hidrogênio inters ticial para a reconstituição do complexo [OH]. [CN]. Sabe-se que a molécula OCN é um defeito estável, assim como as impurezas OH e CN, e portanto, é pouco provável a ocorrência da quebra da ligação O - CN, estando a molécula no estado eletrônico fundamental, somente com a energia têrmica fornecida.

Devido ao fato de não conhecermos as intensidades de oscilador das novas absorções 0. OH . CN , não foi possível calcular as concen е trações destes defeitos pelo método utilizado em itens anteriores. Assim, para um estudo quantitativo dos resultados, considerando que a densidade óptica é diretamente proporcional a concentração do defeito, realizamos a comparação entre as densidades ópticas inicial e final (após a aplicação de um pulso) de cada absorção. Com este procedimento, observamos que, após o pulso de 120 K, são recons truídos 18% dos defeitos [OH] . [CN] destruídos com a irradiação UV; simultaneamente, são destruídos 22% dos defeitos 0 . CN produzidos após a fotodissociação. Isto significa que praticamente todos os centros X destruí dos com o aumento da temperatura (até 120 K) recombinamse com centros U2, reconstituíndo os centros agregados. Este mecanismo pode ser descrito pela equação:

$$\begin{bmatrix} O^{-} & CN^{-} \end{bmatrix} + H_{1}^{O}(\text{instavel}) + KT \longrightarrow \begin{bmatrix} OH^{-} & CN^{-} \end{bmatrix}$$

$$(4.19)$$

A recombinação descrita pela equação (4.19) surge na amostra 1200 como um canal de reação adicional para a estabilização de centros intersticiais de hidrogênio, competindo com a formação de centros U_{2x} e centros H_2^{0} .

Na faixa de temperatura 170 a 250 K, ocorrem deslocamentos da linha base na região UV, tornando muito difícil uma análise precisa dos resultados. Conforme mencionamos no capítulo II, centros F podem auxiliar o estudo do processo de fotodissociação a temperaturas próx<u>i</u> mas à temperatura ambiente (devido a sua associação à alguns produtos secundários). Realizamos então, para sequência de nosso estudo, experiências com amostras coloridas, as quais serão apresentadas no ítem a seguir.

IV.3.5 - RbC1 - 1200 e centros F

A introdução de centros F no cristal 1200 foi realizada, inicialmente, com a intenção de exte<u>n</u> der nosso estudo à dinâmica dos produtos secundários da fotodissociação de fons OH pertencentes ao agregado, à temperaturas acima de 170 K. Entretanto, verificamos que o processo de coloração, como veremos a seguir, leva à destruição dos centros OH. OH.

A figura 4.12a mostra o espectro de absorção, à temperatura ambiente, da amostra 1200 após o

73.



FIGURA 4.12. Processo de coloração aditiva. (a) Espectro de absorção óptica, a temperatura ambiente, do cristal RbC1-1200. (b) Espectro de absorção óptica, a temperatura ambiente, do cristal RbC1-2080.

.

TO A LAND IN TELENGIA LUCLEAR SP

• • • • • •

processo de coloração aditiva. Além da absorção caracterís tica de centros F na região visível, temos uma intensa absorção em 2280 $\stackrel{o}{A}$ e uma segunda absorção, bem menos intensa, em 2720 $\stackrel{o}{A}$. De acordo com a literatura, a primeira absorção corresponde a centros U (íons de hidrogênio em posições substitucionais); a segunda absorção não foi identi ficada. A figura 4.12b mostra o espectro de absorção, tam bém à temperatura ambiente, da amostra 2080 após ser submetida a processo idêntico de coloração. A absorção $\stackrel{o}{OH}$ permanece inalterada, sendo formados somente centros F.

Conforme mencionado no capítulo III, 0 processo de coloração aditiva implica em um aquecimento do cristal a temperaturas próximas de seu ponto de fusão. Α presença de impurezas no tubo de coloração poderia, portanto, levar a reações espúrias, alterando a concentração de defeitos ou impurezas já presentes na amostra. A fim de verificarmos se a produção de centros U, observada na amos tra 1200, é devida a presença dos agregados OH . CN colorimos amostras dos cristais 1200 e 2080, a temperatura ambiente, por irradiação X. A figura 4.13 mostra os resul tados obtidos. Conforme pode ser observado, temos, novamente, na amostra 1200 a produção de centros U e F com a destruição da absorção relativa aos agregados e a formação de centros F na amostra 2080, sem alteração na absorção A partir da equação (3.2) (Capítulo III) e da figu OH . ra 4.13, calculamos a concentração de centros de cor em ambas as amostras. A tabela VII fornece os resultados obtidos e os parâmetros utilizados neste cálculo.

75.



FIGURA 4.13. Irradiação com raios X a temperatura ambiente. (a) Espectro de absorção óptica, a temperatura ambien te, do cristal RbCl-1200. (b) Espectro de absorção úptica, a temperatura ambiente, do cristal RbCl-2080.

I

	D.O.	d (mm)	$n(F/cm^3)$
RbCl - 2080	0,62	0,35	1,8x10 ¹⁷
RbCl - 1200	1,52	1,20	1,3x10 ¹⁷

TABELA VII. Concentração de centros F nas amostras 1200 e 2080 após irradiação X

Embora as amostras tenham sido irradiadas por períodos idênticos e em condições análogas, a concentração de centros F na amostra 2080 é maior do que a concentração na amostra 1200.

A diferença entre a amostra 2080 e 1200 é a presença de impurezas 🔼 na segunda, portanto a produção de centros U, observada nesta amostra, bem como а menor concentração de centros F detectada, está relacionada a presença dos agregados OH . CN . Não se conhece até o presente na literatura um efeito semelhante a este, isto é, que centros U possam ser criados diretamente da irradiação de haletos alcalinos dopados com impurezas OH_ ou mesmo ainda, que a coloração aditiva destas amos tras produza centros U além de centros F. Processos de hidrogenação (formação de centros U) posteriores ou simultâneos à coloração aditiva são sempre realizados na presen ça de hidrogênio e sob alta pressão (- 20 atms), caso total mente distinto de nossa situação experimental, em que a coloração aditiva foi realizada sob baixa pressão de potássio (~ 1 atm), sendo a pressão de vapor controlada com gás n<u>i</u> trogênio (princípio do "heat-pipe") conforme descrito no c<u>a</u> pítulo III.

Para um estudo mais detalhado deste processo, submetemos uma amostra do cristal 1200 à irradiação X por 30 minutos e realizamos nova medida de absorção óptica à temperatura de 80 K. Este procedimento nos permite obter uma melhor resolução do espectro da amostra irra diada, conforme mostra a figura 4.14. Além da absorcão relativa aos agregados em 1940 A, observa-se também [CN] em 2040 A. absorção relativa aos defeitos 0. Conforme vimos no ítem IV.3.3 o centro X é um dos produtos primários da fotodissociação do agregado [OH] . |; logo concluimos que o efeito primário da radiação X é a fotodissociação da impureza OH pertencente ao agregado, levando a formação de centros U_2 e $\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$. CN . Contudo, como os centros U₂ são instáveis à temperatura ambiente, os defeitos de hidrogênio estabilizam-se como centros υ.

Irradiando-se a amostra 1200, à tempera tura ambiente, com luz UV, observamos, também, a formação de centros U, X e F, mas com concentrações menores. A radiação X cria excitons de alta energia, que se aniquilam na própria rede, formando centros F e centros de buraco. A radiação UV também leva a produção de pares elétronburaco que se aniquilam na rede; entretanto, a velocidade de formação de defeitos é muito menor, devido ã diferença



FIGURA 4.14. Espectro de absorção óptica,a temperatura de 80K, do cristal RbC1-1200 após irradiação com raios X.

de energia. Além disto, a probabilidade de estabilização de centros U₂ na forma de centros U na fotodissociação do agregado [OH]. [CN]], pela irradiação X, será maior quando comparada à irradiação UV, devido à produção simult<u>â</u> nea de elevadas concentrações de centros F.

O estudo do espectro de absorção à baixa temperatura, na amostra 1200 colorida aditivamente, revelou algumas alterações em relação à amostra irradiada (Figura 4.15). Observa-se, na coloração aditiva, as absor ções OH , U e várias absorções pouco OH intensas na região de 2500 a 4500 Å. Embora não seja observada a presença de centros X, é possível que o processo de produção de centros U seja análogo à amostra irra diada. Como o processo de coloração aditiva se desenvolve a altas temperaturas, é provável que os centros X sofram reações de dissociação e associação com a consequente for mação de outros defeitos, resultando em novas absorções como as observadas na região de 2500 a 4500 A. Neste ponto, cabe destacar que realizamos tratamentos térmicos da amostra 1200 à temperatura da coloração aditiva e observamos que a banda devida ao agregado decai, restando OH_ sem a formação de centros U. apenas centros

Destes resultados, concluímos que a produção de centros U nos processos de coloração da amostra esta relacionada não somente à presença de agregados [OH]. [CN], mas também a presença de centros F. Estes centros, produzidos na irradiação X e coloração

80.



FIGURA 4.15. Espectro de absorção óptica, a temperatura de 80K, do cristal RbC1-1200 após coloração aditiva.

aditiva, atuam simultaneamente como armadilhas para os centros U₂ (instáveis) resultantes da dissociação do agregado [OH . CN], levando à formação de centros U e, consequentemente, à formação de menos centros F na amostra 1200.

CAPÍTULO V

CONCLUSÕES

Os resultados apresentados e discutidos neste trabalho fornecem algumas contribuições referentes a fenômenos ligados à dinâmica de associação e dissocia ção dos produtos da fotodissociação da impureza OHT em cristais de cloreto de rubídio, bem como informações iné ditas resultantes do processo de fotodissociação OHT em presença da impureza molecular CNT.

O processo de fotodissociação no cristal RbCl: OH é análogo ao observado em cristais de KCl: OH, não sendo detectadas alterações devido ao maior parâmetro da rede cristalina, exceto o desloca mento das bandas de absorção para regiões de menor energia, resultado já esperado, uma vez que a maior parte da energia de ligação de cristais iônicos é devida a inte rações de natureza eletrostática. O processo de fotodis sociação OH no RbCl é descrito, portanto, pela equa ção abaixo, análoga à proposta inicial de Kerkoff para cristais KC1:

$$OH^{-} + h\nu \xrightarrow{T<100 \text{ K}} H_{i}^{O} + O^{-}$$

O processo de fotodissociação no cristal RbCl: OH⁺ + CN⁻ apresentou resultado diverso devido à interações das impurezas OH e CN . Estas interações foram explicadas com base no modelo proposto, onde te mos um agregado composto por estas duas impurezas em posi ções substitucionais próximas. A ocorrência de impurezas CN e a consequente existência de defeitos agregados [OH . CN] introduzem novos estados energéticos no "gap" do cristal. À temperatura ambiente, este complexo apresenta uma absorção eletrônica em 1960 A e uma absor ção vibracional-rotacional em aproximadamente 4,6 µm.

À temperatura de 80 K, a absorção eletrônica apresenta uma largura de linha estreita e um deslo camento de seu máximo de absorção para 1940 Å. A impureza \overrightarrow{OH} pertencente ao complexo $\left[\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{CN}\right]$, à esta temperatura, fotodissocia-se por irradiação UV na banda \overrightarrow{OH} segundo a equação:

 $\left[\begin{array}{c} OH^{-} \\ OH^{-} \\ \end{array}\right] + h\nu \xrightarrow[T=80 \ K]{} H_{i}^{O} + \left[\begin{array}{c} O^{-} \\ O^{-} \\ \end{array}\right]$

onde temos a formação de centros U_2 e um novo defeito, o qual denominamos inicialmente centro X, formado por um centro substitucional de oxigênio em uma posição próxima a um ion $\boxed{\mathbb{CN}^{-}}$. Este defeito apresenta uma absorção eletr<u>ô</u> nica em 2040 $\stackrel{\circ}{\mathrm{A}}$ com uma largura de linha bastante estreita.

O complexo [OH]. CN] permite, tam bém, a fotodissociação da impureza OH] à temperatura ambiente, por irradiação X e UV, sendo a equação de fot<u>o</u> dissociação, neste caso, dada por:

C3.....

DE ENERGIA NUCLEAR SP

rede +
$$\left[OH^{-} \cdot CN^{-} \right]$$
 + hv $\xrightarrow{T=300K} H^{-} + \left[O^{-} \cdot CN^{-} \right]$ + $\left[e^{-} \right]$

onde são produzidos centro U, X e F respectivamente. A irra diação provoca a dissociação do fon OH pertencente ao agregado levando à formação de centros X e U_2 , os quais são estabilizados na forma de centros U, devido à presença de centros F (que também são formados durante a irradiação) e à estabilidade do defeito X à temperatura ambiente. Na amostra RbCl:OH, isto é, na ausência de impurezas CN, mesmo com a produção simultânea de centros F, pelo fato dos dois produtos primários da fotodissociação OH serem al tamente instáveis, prevalece o processo de recombinação, de tal forma que após a irradiação, a banda OH permanece inalterada, não sendo produzidos centros U. A concentração de centros F e U produzidos por irradiação X é maior do que na irradiação UV. Isto decorre do fato das energias nos dois tipos de radiação serem distintas.

A coloração aditiva de amostras RbCl:OH + CN⁻ leva diretamente à produção de centros U e F, de forma análoga aos processos de irradiação. Este efeito não é observado em amostras RbCl:OH⁻; a banda OH⁻, neste caso, permanece inalterada, de forma análoga a outros hal<u>e</u> tos alcalinos dopados com impurezas OH⁻ coloridos aditivamente.

O modelo proposto no estudo da fotodissociação no RbCl: OH⁻ + CN⁻, baseado na interação entre as duas impurezas moleculares, é desta forma fundamentado pelos nossos resultados experimentais. Entretanto, outros trabalhos certamente são necessários para a elucidação da configuração (ou simetria) do defeito agregado [CN], que consequentemente, possibilite um co OH_ • nhecimento mais detalhado das interações entre estas duas impurezas. Entre muitos trabalhos possíveis poderíamos citar um estudo abrangente de transições vibracionais, uti lizando-se cristais dopados, de forma controlada com CN e OH para obtenção de maiores informações quanto às possíveis pertubações induzidas pelos dois ions molecu lares.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) TKACH, R.W.; GOSNELL, T.R.; SREVERS, A.J. "Solid State vibrational laser KBr:CN" Optics Lett. 10:4, April 1984.
- (2) GOMES, L. e MORATO, S.P. Comprehensive study on the OH photodissociation in alkali halides. In: Proceedings of International Conference on Defects in insu lating crystals held in Salt Lake City, 20-24 August, Utah, 1984. pg. 184.
- (3) MARTIENSSEN, W. J. Phys. Chem. Solids, 2:257, 1957.
- (4) SONDER, E.; SONBLEY, W.A. Defect creation by radiation in polar crystals. In: CRAWFORD Jr., J.H., ed. <u>Point</u> <u>defects in solids</u>, v.l. New York, N.Y., Plenum, 1972. p. 201-90.
- (5) TOYOZAWA, Y. In: Proceedings of the 1974 international conference on Color Center in Tonic Crystals, Sendai, Japan. ref. D43.
- (6) SCHULMAN, J.H.; COMPTON, W.D. "<u>Color Centers in Solids</u>" Oxford, Pergamon, 1963. (International series of monographys on solid state physics, v.2).
- (7) PAUS, H.; LUTY, F. "Density and lattice parameter measurements on the system KCl + KOH". <u>Phys. Status</u> <u>Solidi</u> <u>12</u>:341, 1965.

- (8) ETZEL, H.W.; PATTERSON, D.A. "Optical properties of alkali halides containing hydroxyl ions". <u>Phys.Rev</u>. <u>112</u>(4):1112, 1958.
- (9) ROLFE, J. "Hidroxide absorption band in alkali halides crystals". Phys. Rev. Lett. 1:56, 1958
- (10) FRITZ, B.; LUTY, F.; ANGER, F. "Der einfluß von OHionen auf absorptionsspektrum und ionen leitfä--kigkeit von KCl-eikristalln". <u>Z. Phys</u>. <u>174</u>:240, 1963.
- (11) CHAU, C.K.; KLEIN, M.V.; WEDDING, B. "Photon and phonon interactions with OH" and OD" in KCl". <u>Phys. Rev</u>. <u>Lett.</u> <u>17</u>:521, 1966.
- (12) D. HARRISON and LUTY, F. <u>3ull. Am. Phys. Soc</u>. <u>12</u>:82, 1967.
- (13) WEDDING, B.; KLEIN, M.V. "Infrared absorption of the hydroxyl ion in alkali halide crystals". <u>Phys. Rev.</u> <u>177</u>(3):1274, 1969.
- (14) KOSTLIN, H. "Fluoreszenz hydroxydhaltiger alkalihalogenide". Z. Phys. 204:290, 1967.
- (15) HILSCH, R.; POHL, R.W. "Einige dispersionsfrequezander alkalihalogenid-kristalle im schumanngebiet". <u>Z</u>. <u>Phys. 59</u>:812, 1930.
- (16) CHAE, D.G.; DICK, B.G. "Charge transfer excited states of hydroxyl ion impurities in alkali halide crystals". J. Phys. Chem. Solids <u>34</u>:1683, 1973.

- (17) KAPPHAN, S.E. "A study of paraeletric defects in alkali halides crystals with and optical and caloric methods. Utah, 1976 (Tese de Doutoramento).
- (18) KERKOFF, F. "Zum photochemischen Verhalten sauerstoffhaltiger Komplexe in alkalihalogenic-Kristallen". <u>Z. Phys. 158</u>:595, 1960.
- (19) KERKOFF, F.; MARTIENSSEN, W.; SANDER, W. "Elektronenspen--resonanz und photochenaie des U₂-zentrums in alkalihalogenid-Kristallen". <u>Z. Phys</u>. <u>173</u>:184, 1963.
- (20) SPAETH, J.M.; STURM, M. "ESR and ENDOR investigation of intersticial hydrogen atoms in alkali halides. I. Experimental results. <u>Phys. Status Solidi</u> <u>42</u>: 739, 1970.
- (21) MORATO, S.P. "Photodestruction and reactions of OH ions and H defects in KCl crystals". Utah, 1975. (Tese de Doutoramento).
- (22) MORATO, S.P.; LUTY, F. "Hydrogen defects from UV photodissociation of OH centers in alkali halides". Phys. Rev. B 22(10):4980, 1980.
- (23) CAPE, J.A. "Photochemically Produced Color Centers in KCl and KBr". Phys. Rev. <u>122</u>(1):18, 1969.
- (24) SPAETH, J.M.; SIEDEL, H. "ESR and ENDOR investigation of intersticial hydrogen atoms in alkali halides.
 II. Theoretical interpretation. <u>Phys. Status Solidi</u>
 (b) 46:323, 1971.

- (25) FISCHER, F. und GRÜNDIG, H. "Optische absorption und photochemisches Verhalten von SH, S und S Zetren in KCl - Kristallen. Z. Phys. 184:299, 1965.
- (26) ROLFE, J. "Optical properties of the hydrosulfide ion in KCl and KBr crystals". <u>Appl. Phys. Lett</u>. <u>6</u>(4):66, 1965.
- (27) SPAETH, J.M. "Elektranen-Kern-doppelresonanz-untersuching von U₂-zetren in Kaliumchlorid". <u>Z. Phys</u>. <u>192</u>:197, 1966.
- (28) KURZ, G. "OH dissociation and U₂ decomposition in Hydroxide-doped KCl and KBr crystals. <u>Phys. Status</u> <u>Solidi</u> <u>31</u>:93, 1969.
- (29) RUSCH, W. e SEIDEL, H. "The F center containing a water molecule". <u>Solid State Commun</u>. <u>9</u>:231, 1971.
- (30) RUSCH, W.; SEIDEL, H. "The H₂O⁻ centre in KCl: and F-like paramagnetic and paraeletric defect". <u>Phys.</u> <u>Status Solidi</u> 63:183-95, 1974.
- (31) GOMES, L. "Centros H₂0⁻ em haletos alcalinos com OH⁻: propriedades e cinética de formação - destruição posterior ao dano de radiação. Dissertação de Mestr<u>a</u> do. IPEN. 1979.
- (32) POHL, R.W. "Electron conductivity and photochemical processes in alkali-halides crystals". <u>Proc. Phys.Soc</u>. <u>49</u>(II):3, 1937.

- (33) HISCH, R.; POHL, R.W. <u>Trans. Faraday Soc</u>. <u>34</u>, 883, 1938.
- (34) SCHAEFER, G. "The IR-spectrum of the U-center. <u>J.Phys</u>. Chem. Solids 12:233, 1960.
- (35) DELBECQ, G.J.; SMALLER, B.; YUSTER, P.H. "Paramagnetic resonance investigation of irradiated KCl crystals containing U-centers. Phys. Rev. <u>104</u>:599, 1956.
- (36) HAYES, W.; HODB", J.W. An investigation of X-irradiated KCl:H^{*}e NaCl:H^{*}. <u>Proc. R. Soc</u>. (London) <u>A294</u>: 359, 1966.
- (37). MARKHAM, J.J. "F centers in alkali halides". Solid State Physics. Advances in Research and Applications (supplement 8), 1966.
- (38) PAM, D.S.; LUTY, F. "Defect pair of F centers and substitutional H⁻ ions (U centers) in alkali halides. Resonance Raman study". Phys. Rev. B 18:1868, 1978.
- (39) van DOORN, C.Z. "Method for heating alkali halides and other solids in vapors of controlled pressure". <u>Rev</u>. <u>Sci. Instrum.</u> 32:755, 1961.
- (40) MOLLENAUER, L.F. "Apparatus for the coloration of laser-quality alkali halide crystals. <u>Rev. Sci.</u> <u>Instrum.</u> <u>49</u>(6):809, 1978.
- (41) HEYDEN, E.; FISCHER, F. Ultraviolet absorption and emission of CN⁻ centers in alkali halides". <u>Phys.</u> <u>Status Solidi</u> (B) 69:63, 1975.

- (42). NARAYANAMURTI, V.; POHL, R.O. "Tunneling States of Defects in Solids. <u>Rev. Mod. Phys</u>. <u>42</u>(2), 201,1970.
- (43) SEWARD, W.D.; NARAYANAMURTI, V. "Rotational Degrees of Freedom of Molecules in Solids. I. The cyanide ion alkali halides. <u>Phys. Rev. 149</u>(1):463, 1966.